

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of: Bruno GHYSELEN et al.

Confirmation No. 9075

Application No.: 10/637,078

Group Art Unit: 1765

Filing Date: August 6, 2003

Examiner:

Atty. Docket No.: 4717-6400

For METHOD AND APPARATUS FOR
ADJUSTING THE THICKNESS OF A THIN
LAYER OF SEMICONDUCTOR MATERIAL

SUBMISSION OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENTS

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

Applicants have claimed priority under 35 U.S.C. § 119 of French
Application Nos. FR 0210208 and FR 0210209, both filed on august 12, 2002 in France.
In support of this claim, certified copies of said applications are submitted herewith.

No fee or certification is believed to be due for this submission. Should
any fees be required, however, please charge such fees to **Winston & Strawn LLP**
Deposit Account No. 50-1814.

Date: 4/19/04

Respectfully submitted,


Allan A. Fanucci (Reg. No. 30,256)

WINSTON & STRAWN LLP
CUSTOMER NO. 28765
(212) 294-3311

Enclosures

NY:857847.1



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 18 SEP. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

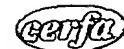
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

1er dépôt

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*02

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 010801

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE

LIEU

12 AOUT 2002

75 INPI PARIS

N° D'ENREGISTREMENT

0210208

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE

12 AOUT 2002

PAR L'INPI

Vos références pour ce dossier

(facultatif)

239603 D19989 JC

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

Cabinet REGIMBEAU

20, rue de Chazelles

75847 PARIS CEDEX 17

FRANCE

Confirmation d'un dépôt par télécopie

☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie

2 NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de brevet

☒

Demande de certificat d'utilité

☐

Demande divisionnaire

☐

Demande de brevet initiale

N°

Date

ou demande de certificat d'utilité initiale

N°

Date

Transformation d'une demande de

☐

brevet européen Demande de brevet initiale

N°

Date

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

PROCEDE D'ELABORATION DE COUCHES MINCES DE SEMI-CONDUCTEUR COMPRENANT UNE ETAPE DE FINITION

4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☐ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)

☐ Personne morale

☒ Personne physique

Nom
ou dénomination sociale

S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES

Prénoms

Forme juridique

SOCIETE ANONYME

N° SIREN

384711909

Code APE-NAF

Domicile

Rue

Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques,

ou

siège

Code postal et ville

38190 BERNIN

Pays

FRANCE

Nationalité

Française

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

☐ S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

Remplir impérativement la 2^{ème} page

REMISE DES PIÈCES DATE 12 AOUT 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0210208 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI DB 540 W / 010801
Vos références pour ce dossier : (facultatif) 239603 JC		
6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)		
Nom Prénom Cabinet ou Société N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel Adresse Rue Code postal et ville Pays N° de téléphone (facultatif) N° de télécopie (facultatif) Adresse électronique (facultatif)		Cabinet REGIMBEAU 20, rue de Chazelles 75847 PARIS CEDEX 17 01 44 29 35 00 01 44 29 35 99 info@regimbeau.fr
7 INVENTEUR (S)		
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
8 RAPPORT DE RECHERCHE		
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI L. MARIELLO

La présente invention concerne la fabrication de composants semi-conducteurs pour la micro-électronique et/ou l'optoélectronique.

Plus précisément, l'invention concerne un procédé de correction de l'épaisseur d'une couche mince de matériau semiconducteur, comprenant les
5 opérations suivantes :

- acquisition d'au moins une mesure d'épaisseur de la couche,
- détermination de spécifications de correction d'épaisseur à appliquer à la couche, en fonction de(s) mesure(s) d'épaisseur acquise(s),
- correction de l'épaisseur de la couche selon lesdites spécifications de
10 correction.

Et l'invention concerne également un dispositif associé.

De telles couches minces sont réalisées au terme d'une chaîne de fabrication comportant plusieurs étapes successives.

Le procédé Smart-Cut[®] est un exemple de type de procédé permettant de
15 réaliser des couches minces.

On trouvera dans l'ouvrage « Silicon-On-Insulator Technology : Materials to VLSI, 2nd Edition » de Jean-Pierre COLINGE une description en général de ce type de procédé « voir en particulier pages 50 et 51).

Dans une variante, ce type de procédé comprend les étapes suivantes :

20 Lors d'une première étape, on oxyde au moins une face d'une plaque de matériau semi-conducteur.

Lors d'une deuxième étape, on crée par implantation ionique, une zone de fragilisation sous une face de la plaque.

Lors d'une troisième étape, dite de collage, cette face de la plaque est
25 reportée sur un substrat support et rendue solidaire de celui-ci.

Lors d'une quatrième étape, l'ensemble constitué par la plaque et le substrat support est soumis à un traitement apte à créer un détachement de la plaque au niveau de la couche d'implantation.

Lors d'une cinquième étape, des techniques de finition sont mises en



œuvre pour permettre notamment de diminuer les défauts engendrés par le détachement, et/ou retrouver un niveau de rugosité suffisamment faible.

Le procédé Smart-Cut® permet aussi de réaliser des structures multicouches de type SOI, acronyme anglo-saxon de Silicon On Insulator, en gardant sur la face d'implant de la plaque une couche d'oxyde, créée lors de la première étape, afin d'intercaler, lors de l'étape de collage, la couche d'oxyde entre le substrat support et la plaque.

Les étapes 101 à 105 de fabrication d'une structure SOI selon un mode de réalisation du procédé Smart-Cut® sont ainsi illustrées sur la figure 1.

10 Ces étapes sont les suivantes :

- étape 101 d'oxydation,
- étape 102 d'implantation,
- étape 103 de collage,
- étape 104 de traitement pour créer un détachement de couche,
- 15 • étape 105 de finition.

On précise qu'il existe également d'autres types de procédés permettant de fabriquer des structures SOI.

Quel que soit le type de procédé mis en œuvre, chaque nouvelle étape incluse dans une chaîne de fabrication demande nécessairement des manipulations et/ou des interventions sur ces couches, et implique donc des risques supplémentaires de défauts de fabrication.

Les défauts peuvent se traduire en particulier par des écarts d'épaisseurs d'une couche par rapport aux spécifications d'épaisseurs requises par le fabriquant.

25 Ces défauts sont à l'origine de nombreux rejets de couches :

- d'épaisseur moyenne de la couche,
- et/ou d'uniformité de l'épaisseur à la surface d'une même couche (uniformité dite « within wafer » selon la terminologie anglo-saxonne, que l'on traduira dans ce texte par « uniformité intracouche »),

On précise en outre que les couches sont habituellement fabriquées par lots, une même épaisseur – cible étant désirée pour toutes les couches du lot (avec une tolérance donnée).

Il en résulte qu'il est également souhaité de respecter des spécifications d'uniformité d'épaisseur entre les différentes couches d'un même lot (uniformité « wafer to wafer » selon la terminologie anglo-saxonne, que l'on traduira dans ce texte par « uniformité intercouches »).

Des étapes de contrôle d'épaisseur mettant en œuvre des techniques de mesures d'épaisseur des couches minces sont donc habituellement intercalées entre certaines étapes d'élaboration, tout au long de la chaîne de fabrication.

Ces étapes de contrôle impliquent le rejet des couches qui présentent des défauts d'épaisseur préjudiciables au bon fonctionnement des futurs composants électroniques.

Reprenant l'exemple des principales étapes du procédé de type Smart-Cut® d'élaboration de SOI illustré sur la figure 1, les étapes de contrôle d'épaisseur sont schématisées par des losanges 107 et peuvent être situées en aval de certaines étapes du procédé d'élaboration de SOI : après l'étape 101 d'oxydation, après l'étape 102 d'implantation ionique, après l'étape 103 de collage, après l'étape 104 de traitement thermique, après l'étape 105 de finition.

On précise que la représentation de la figure 1 est une représentation « maximaliste », les étapes de contrôle n'ayant généralement pas lieu après chacune des étapes du procédé d'élaboration du SOI.

Si les épaisseurs mesurées d'un élément (substrat, couche ou ensemble des deux) sont satisfaisantes, l'élément passe à l'étape suivante. Sinon, l'élément est rejeté en 108.

Ce type de procédé classique, incluant de multiples étapes de contrôle d'épaisseur des couches, conduit à de grandes pertes de matériaux, ainsi qu'à un ralentissement conséquent de la chaîne de fabrication.

Une solution pour réduire ces inconvénients consisterait à supprimer ces contrôles d'épaisseur successifs, ou à assouplir les contraintes qui leur sont liées, en instaurant en fin de fabrication une correction d'épaisseur.

Une telle correction d'épaisseur pourrait par exemple comprendre les
5 opérations suivantes, pour chaque couche :

- acquisition d'au moins une mesure d'épaisseur de la couche,
- détermination de spécifications de correction d'épaisseur à appliquer à la couche, en fonction de(s) mesure(s) d'épaisseur acquise(s),
- correction de l'épaisseur de la couche selon lesdites spécifications de
10 correction.

Il serait en effet possible de calculer pour chaque couche des spécifications de correction d'épaisseur « personnalisées », en fonction des mesures effectuées sur la couche et d'une cible d'épaisseur désirée pour la couche.

15 Un tel calcul devrait alors être répété pour chaque couche, de manière à recréer pour chaque couche des spécifications de correction d'épaisseur.

Or, ceci correspondrait à une quantité de calculs qui ne sont pas nécessaires dans certains cas.

En particulier, dans le cas de la fabrication de couches par lots, les
20 couches d'un même lot peuvent présenter avant correction des épaisseurs relativement similaires, du fait que ces couches ont généralement subi ensemble les étapes précédentes du procédé d'élaboration (recuits, etc...).

Dans un tel cas, la répétition de calculs complets de manière à recréer des spécifications individuelles pour chaque nouvelle couche du lot peut ainsi
25 correspondre à un gaspillage de ressources de calcul, et de temps.

Et on pourrait de manière générale souhaiter alléger -et simplifier l'opération de détermination de spécifications de correction d'épaisseur à appliquer à la couche.

En effet, les cibles en termes d'épaisseur de couche, bien qu'étant strictes, autorisent cependant des tolérances. Il n'est ainsi pas réellement nécessaire de créer des spécifications de correction d'épaisseur individualisées pour chaque couche, pour autant que les spécifications de correction associées à chaque couche permettent de commander une opération de correction d'épaisseur permettant d'atteindre la cible d'épaisseur, moyennant les tolérances.

Le but de l'invention est de répondre au besoin décrit ci-dessus.

Afin d'atteindre ce but, l'invention propose selon un premier aspect un procédé de correction de l'épaisseur d'une couche mince de matériau semiconducteur, comprenant les opérations suivantes :

- acquisition d'au moins une mesure d'épaisseur de la couche,
- détermination de spécifications de correction d'épaisseur à appliquer à la couche, en fonction de(s) mesure(s) d'épaisseur acquise(s),
- correction de l'épaisseur de la couche selon lesdites spécifications de correction,

caractérisé en ce que la détermination des spécifications de correction comprend :

- l'établissement d'un profil d'épaisseur de la couche, à partir des mesures d'épaisseur acquises,
- la comparaison dudit profil avec des profils-types mémorisés, chaque profil-type étant mémorisé en association avec des spécifications de correction d'épaisseur (ou recettes) respectives, et
- la sélection d'un profil-type mémorisé, pour associer à la couche dont on souhaite corriger l'épaisseur, les spécifications de correction d'épaisseur mémorisées en association avec le profil-type choisi.

Des aspects préférés, mais non limitatifs du procédé selon l'invention sont les suivants :

- le procédé comprend une configuration permettant d'établir des associations entre les profils-types mémorisés et les recettes,
- ladite configuration est réalisée par un algorithme dont une donnée d'entrée est une spécification-cible de profil d'épaisseur (ou « cible ») établie pour la fabrication de couches,
- les mesures d'épaisseurs, les profils-types et la cible sont définis selon des maillages identiques,
- à chaque changement de cible, l'algorithme de configuration est automatiquement réactivé pour établir une nouvelle configuration définissant des correspondances entre les profils-types et les recettes,
- le procédé comprend la mémorisation d'au moins une configuration,
- le procédé comprend la mémorisation de plusieurs configurations, ainsi que la sélection d'une configuration désirée,
- les profils-types et/ou les recettes font l'objet d'un classement selon une arborescence définissant des catégories et sous catégories avec un nombre de niveaux désiré,
- on peut sélectionner des zones de l'arborescence de profils-types dans lesquelles chercher pour réaliser la sélection d'un profil-type,
- l'arborescence des recettes est définie par des niveaux de détail de plus en plus fins en descendant l'arborescence,
- pour établir une configuration, l'algorithme de configuration cherchant une recette à associer à un profil-type ne cherchera pas dans toutes les recettes, mais sélectionnera d'abord des catégories de recettes en fonction des écarts d'épaisseur entre la cible et le profil-type,
- on établit pour la configuration un lien entre un niveau donné d'une arborescence de profils-types (« niveau de départ ») et un niveau donné d'une arborescence de recettes (« niveau d'arrivée »), de sorte que pour chaque profil-type rattaché à une catégorie donnée de ce niveau de départ, il existe une catégorie du niveau d'arrivée des recettes, et lors de la

configuration, toute recherche d'une recette pour un profil-type de ce niveau de départ sera automatiquement dirigée vers ladite catégorie de niveau d'arrivée, la recherche se poursuivant ensuite en descendant l'arborescence des recettes,

- 5 ◦ l'arborescence des recettes est définie par paramètres de recettes,
- dans l'arborescence des recettes les catégories de plus haut niveau de recettes comprennent :
 - 10 ➤ une première catégorie de plus haut niveau de recettes qui définissent une spécification de correction d'épaisseur uniforme pour toute la surface de la couche,
 - et d'autres catégories de plus haut niveau, selon des paramètres globaux de répartition des spécifications de correction d'épaisseur sur cette surface,
- 15 ◦ la correction d'épaisseur est appliquée simultanément sur toute la surface d'une couche, avec possibilité de différencier ladite correction selon l'endroit de la surface de la couche,
- la correction de l'épaisseur de la couche fait intervenir une oxydation sacrificielle,
- 20 ◦ les couches sont traitées par lots, l'épaisseur d'une couche d'un lot étant mesurée tandis que l'épaisseur d'une couche précédant ladite couche mesurée dans le lot avec un pas donné est corrigée,
- les couches d'un même lot partageant une même cible d'épaisseur finale, la sélection de recette pour chaque couche est individualisée de manière à obtenir pour le lot, une fois la correction d'épaisseur effectuée, une
25 épaisseur moyenne de couche la plus proche de la cible commune,
- des recettes correspondent à une modification d'épaisseur uniforme sur toute la couche,
- des recettes correspondent à une modification d'épaisseur différenciée sur la surface de la couche,

Selon un deuxième aspect, l'invention propose également un dispositif de mise en œuvre d'un procédé du type mentionné ci-dessus, caractérisé en ce que le dispositif comprend :

- des moyens de mesure d'épaisseur,
- 5 • des moyens de correction d'épaisseur,
- une unité de traitement, associée à des moyens de mémorisation de spécifications de correction d'épaisseur, et reliée aux moyens de mesure d'épaisseur pour en recevoir des mesures réalisées sur les couches ainsi qu'aux moyens de correction d'épaisseur pour leur transmettre des
- 10 spécifications de correction d'épaisseur.

Des aspects préférés, mais non limitatifs d'un tel dispositif sont les suivants :

- les moyens de mesure d'épaisseur comprennent un ellipsomètre,
- les moyens de mesure d'épaisseur comprennent un réflectomètre,
- les moyens de mesure d'épaisseur comprennent un dispositif de type
- 15 ACUMAP™,
- les moyens de correction d'épaisseur comprennent un dispositif de type RTP XE Centura™.

D'autres aspects, buts et avantages, de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui suit, faite en référence aux dessins

20 annexés sur lesquels, outre la figure 1 citée en introduction et qui représente schématiquement les étapes d'un procédé d'élaboration de structures SOI selon l'état de la technique antérieure à la présente invention :

- La figure 2 représente schématiquement les étapes d'une variante selon la présente invention d'un procédé d'élaboration de structures SOI de type

25 Smart-Cut®,

- La figure 3 est un schéma illustrant un exemple d'association établie entre deux types de paramètres qui peuvent être mémorisés pour mettre en

œuvre l'invention, lors de l'opération de déduction des spécifications de correction d'épaisseur à partir de l'opération de mesure d'une couche mince,

- La figure 4 est un schéma illustrant l'exploitation faite de l'association mentionnée ci-dessus à propos de la figure 3,

5 - La figure 5 représente schématiquement les étapes d'une oxydation sacrificielle d'une couche mince sur substrat,

- La figure 6 représente une vue en perspective d'un dispositif RTO (pour l'acronyme anglo-saxon Rapid Thermal Oxidation - oxydation thermique rapide), mis en œuvre dans l'invention pour la correction d'épaisseur,

10 - La figure 7 représente schématiquement une vue en coupe transversale d'une chambre d'oxydation thermique d'un dispositif RTO, à pression atmosphérique.

- La figure 8 représente schématiquement une vue en coupe transversale d'une chambre d'oxydation thermique d'un dispositif RTO, à pression réduite,

15 - La figure 9 représente, dans un dispositif RTO, des répartitions schématiques de lampes et de sondes entourant des couches minces pouvant avoir des diamètres différents,

- La figure 10 représente un schéma de principe du fonctionnement d'un dispositif RTO,

20 - La figure 11 représente la progression dans le temps d'épaisseurs de couches d'oxyde de silicium formées par RTO pour différentes concentrations de H_2 du gaz oxydant, à pressions réduites et pour une température d'oxydation fixée à $1050^\circ C$,

25 - La figure 12 représente la progression dans le temps d'épaisseurs de couches d'oxyde de silicium formées par RTO pour différentes températures d'oxydation, à pression de 10 Torr et pour une concentration de H_2 fixée à 33% du gaz oxydant,

- La figure 13 représente schématiquement une comparaison en épaisseurs de couches entre un lot de couches n'ayant pas subi de correction



d'épaisseur (13 a), et le même lot après traitement par oxydation sacrificielle, selon deux modes différents (respectivement 13 b et 13 c),

- La figure 14 représente des épaisseurs d'oxyde de silicium, aux tolérances près, formées par RTO pour 700 couches minces, sous oxydation sèche à 1100°C et en 60 secondes.

En préalable à la description qui suit, on précise que par « couche mince » on entend dans ce texte une couche de matériau présentant une épaisseur pouvant aller de quelques Angströms à quelques dizaines de microns.

Une telle couche mince est typiquement réalisée en un matériau semiconducteur tel que du silicium, de préférence par un procédé de type Smart-Cut®.

On précise toutefois qu'une telle couche peut également avoir été obtenue :

- Par une technique de dépôt (par exemple de polysilicium), ou de croissance épitaxiale (par exemple de monosilicium), ou
- Par une technique de transfert de couche autre que la technique Smart-Cut®. A cet égard, la technique de transfert peut en particulier être une technique mettant en œuvre la création d'une zone de fragilisation dans un substrat de matériau semiconducteur, et le détachement au niveau de cette zone pour constituer la couche. On précise en outre que :
 - Le matériau semiconducteur peut être du silicium. Et dans ce cas, la couche peut correspondre à la couche superficielle d'un SOI,
 - Et la technique de transfert, outre une technique de type Smart-Cut®, peut par exemple être une technique de type ELTRAN® ou un autre type de technique de transfert.

Le matériau de la couche peut être un matériau pouvant être oxydé (du type par exemple silicium, mais d'autres matériaux sont envisageables : SiC, SiGe par exemple...).

Cette couche mince est avantageusement solidaire d'un support appelé substrat qui permet en particulier de rigidifier l'ensemble couche-substrat (encore appelé tranche).

5 Ce substrat peut avantageusement comporter un semi-conducteur (par exemple du silicium), ou un empilement de couches semi-conductrices, ou encore des structures non homogènes ou des composants ou des parties de composants à des niveaux plus ou moins avancés de leur élaboration.

10 En référence maintenant à la figure 2, on a illustré un exemple de procédé d'élaboration de couches minces selon l'invention, mettant en œuvre les principales étapes de Smart-Cut®.

Les couches minces de cet exemple sont des couches de silicium d'un SOI.

15 Toutefois, l'invention s'applique à l'élaboration de tous types de couches minces, y compris des couches – par exemple en silicium – construites par croissance épitaxiale (en particulier, silicium monocristallin), ou encore par dépôt (en particulier, silicium polycristallin).

Et l'invention n'est pas non plus limitée à une variante d'un procédé de type Smart-Cut®, mais s'applique à tout type de procédé d'élaboration de couche mince.

20 Toujours en référence à la figure 2, on remarque que par rapport à la représentation de la figure 1, on a supprimé les étapes de contrôle d'épaisseur 107, et évité ainsi de multiplier les pertes et ralentissements du procédé qui en découlent.

25 Et il est également possible de la sorte de relâcher les contraintes associées aux différentes étapes de fabrication des couches, une étape finale de correction d'épaisseur étant comme on va le voir prévu.

On précise toutefois qu'il est éventuellement possible de maintenir dans certaines variantes de l'invention une ou plusieurs étapes de contrôle intermédiaire 107, selon les besoins spécifiques du procédé.

30 Dans le cas de l'invention en effet, c'est lors de la finition (référéncée ici

105') qu'on intervient sur le contrôle de l'épaisseur des couches.

Comme représenté sur la figure 2, la finition 105' comporte une étape 1050' de correction d'épaisseur, qui comporte elle-même trois opérations s'appliquant à chaque couche :

- 5 • acquisition 1051' d'au moins un profil de mesure d'épaisseur de la couche,
- déduction 1052' de spécifications de correction d'épaisseur à appliquer à la couche, à partir du profil de mesure d'épaisseur mesuré en 1051',
- correction d'épaisseur de couche 1053' selon lesdites spécifications.

On précise que par « profil » on entend une représentation de l'épaisseur
10 caractéristique d'une couche.

Un tel profil peut être constitué d'un maillage bi-dimensionnel couvrant toute la surface de la couche. Dans ce cas, un profil de mesure d'épaisseur de la couche consistera en une série de mesures effectuées aux nœuds du maillage.

Il est toutefois possible d'adapter la définition du profil, en fonction de la
15 capacité des machines, du niveau de détail souhaité, et des cadences que l'on souhaite obtenir en particulier.

On pourra ainsi définir de la manière la plus simple un « profil » comme un point de mesure unique.

Et comme on le verra ci-dessous, la notion de « profil » concerne non
20 seulement les mesures réalisées sur les couches, mais de la même manière les spécifications de correction d'épaisseur qui seront transmises aux moyens de correction d'épaisseur pour la mise en œuvre de l'opération 1053'.

L'opération de correction d'épaisseur 1053' met en œuvre une oxydation sacrificielle, comme cela sera détaillé plus loin dans ce texte.

25 L'étape 1050' de correction d'épaisseur peut être suivie d'une finition supplémentaire 1054', mettant en œuvre par exemple un recuit sous hydrogène.

On a également représenté sur la figure 2 une étape de mise au rebut 108, qui peut éventuellement faire suite à l'opération de déduction de

spécifications 1052', au cas où le profil de mesure d'épaisseur de couche acquis en 1051' ne permettrait pas d'appliquer à la couche une correction adéquate pour obtenir un profil d'épaisseur de couche souhaité en sortie de procédé.

5

Acquisition de profil de mesure

Après avoir créé des couches minces lors des étapes 101 à 104 (qui sont identiques à celles décrites en référence à la figure 1, on réalise la finition de chaque couche mince en 105'.

Pour cela, on exécute tout d'abord une étape 1050'.

Cette étape 1050' débute par une acquisition 1051' d'au moins une mesure d'épaisseur d'une couche précédemment élaborée au moyen, par exemple, d'un réflectomètre ou d'un ellipsomètre.

Cette acquisition de mesure d'épaisseur de la couche mince peut être réalisée par un dispositif tel qu'un réflectomètre ACUMAP™ de la société ADE.

A l'issue de l'opération 1051', on dispose ainsi pour chaque couche mince d'un profil d'épaisseur, qui est une cartographie de l'épaisseur de la couche.

On précise que dans un contexte de fabrication industrielle par lots, une couche du lot peut ainsi subir une mesure d'épaisseur, alors que la couche précédente du lot (ou qu'une couche précédente du lot, avec un nombre de couches déterminé entre les deux couches) subit l'opération ultérieure 1053' de correction d'épaisseur que l'on va décrire plus bas dans ce texte.

En tout état de cause, le profil mesuré est transmis par le dispositif de mesure d'épaisseur à une unité de traitement, qui peut par ailleurs être reliée à des moyens de mémorisation aptes à mémoriser les profils mesurés pour

chaque couche.

On précise à cet égard que le dispositif permettant de mettre en œuvre l'invention comporte ainsi :

- 5 • des moyens de mesure d'épaisseur – pouvant consister comme on l'a dit en une machine de type ACUMAP™,
- des moyens de correction d'épaisseur – au sujet desquels on donnera des détails plus bas dans ce texte,
- 10 • une unité de traitement, associée à des moyens de mémorisation (ou « mémoire »), et reliée aux moyens de mesure d'épaisseur (pour en recevoir des mesures réalisées sur les couches) ainsi qu'aux moyens de correction d'épaisseur (pour leur transmettre des spécifications de correction d'épaisseur).

On précise également que l'invention peut être mise en œuvre selon un mode entièrement automatisé dans lequel les différents moyens mentionnés ci-dessus (moyens de mesure d'épaisseur, moyens de correction d'épaisseur, 15 unité de traitement) sont reliés les uns aux autres et sont aptes à échanger automatiquement des informations.

Dans ce cas, le dispositif détermine automatiquement les « recettes » à appliquer, en fonction des mesures d'épaisseur effectuées sur les couches (la 20 notion de recettes sera explicitée ci-dessous).

Il est cependant également possible de mettre en œuvre l'invention dans un mode simplifié, dans lequel ces trois moyens ne sont pas nécessairement reliés entre eux.

Et dans un mode de réalisation particulièrement simple de l'invention, le 25 dispositif ne comprendra pas d'unité de traitement, mais uniquement des moyens de mesure d'épaisseur et des moyens de correction d'épaisseur.

Dans ce dernier mode simplifié, un opérateur observe – par exemple en

temps réel –les mesures d'épaisseur effectuées sur les couches, et entre lui-même des commandes de correction d'épaisseur dans les moyens de correction d'épaisseur, la déduction des corrections d'épaisseur à appliquer étant effectuée par l'opérateur en fonction des mesures d'épaisseur qu'il a constatées.

Déduction de spécifications de correction d'épaisseur

L'opération suivante 1052' consiste à déduire des spécifications de correction d'épaisseur à partir du profil de mesure d'épaisseur.

10 C'est cette opération qui va permettre de traduire les mesures d'épaisseur effectuées sur chaque couche, en une commande des moyens de correction d'épaisseur.

En référence à la figure 3, cette opération de déduction de spécifications de correction d'épaisseur utilise de préférence une « bibliothèque » 40 de spécifications-types de correction d'épaisseur 41 à 49 (que l'on nommera « recettes » dans la suite de ce texte), mémorisée de manière permanente dans les moyens de mémorisation mentionnés ci-dessus, référencés 500.

Chaque recette est un jeu de spécifications destiné à être fourni au dispositif de correction d'épaisseur qui sera mis en œuvre lors de l'opération 1053', pour commander l'action de ce dispositif.

On précise que si les recettes sont mémorisées de manière permanente dans les moyens de mémorisation 500, ces recettes sont cependant évolutives : il est en particulier possible à un opérateur de mettre à jour ces recettes dans la mémoire 500, autant que de besoin.

25 L'opération 1052' consiste ainsi dans ce cas à sélectionner parmi les recettes mémorisées de la bibliothèque 40, celle qui est le mieux adaptée.

Cette sélection peut se faire de plusieurs manières.

Dans un mode de réalisation, on utilise pour effectuer une telle sélection une liste 20 de profils-types d'épaisseur (21 à 27 dans l'exemple de la figure 3).

Et comme représenté sur la figure 3, des correspondances sont établies entre les profils-types d'épaisseur et les recettes. Plus précisément, à chaque profil-type est associée une recette unique.

L'ensemble des associations entre les profils-types et les recettes définit
5 une « configuration » de l'unité de traitement.

On précise que pour une configuration donnée, plusieurs profils-types peuvent être associés à la même recette.

La configuration composée des associations entre les profils-types et les recettes sont également mémorisées dans la mémoire 500.

10 L'invention peut être mise en œuvre de manière complètement automatique ; dans ce cas, cette configuration peut être établie automatiquement par un algorithme, dit de configuration, qui est chargé dans l'unité de traitement.

Plus précisément, une des données d'entrée de cet algorithme de
15 configuration est la spécification-cible de profil d'épaisseur (que l'on nommera « cible » dans la suite de ce texte) qui est établie pour la fabrication de couches.

Cette cible peut être modifiée de temps à autre par un opérateur 600, à l'aide de moyens de saisie associés à l'unité de traitement.

20 Dans tous les cas, elle est mémorisée dans la mémoire 500 (et est désignée par la référence 30).

Et à chaque changement de cible, l'algorithme de configuration mentionné ci-dessus est automatiquement réactivé pour établir une nouvelle configuration définissant des correspondances entre les profils-types de la liste
25 20, et les recettes de la bibliothèque 40 (ces profils-types et ces recettes demeurant mémorisés de manière permanente dans la mémoire 500, et n'étant pas affectés eux-mêmes par les changements de cible).

A chaque nouvelle cible, ledit algorithme de configuration va donc associer à chaque profil-type d'épaisseur une recette, qui représente les
30 spécifications de correction d'épaisseur les plus adaptées pour atteindre la cible

en partant de ce profil-type.

Par « spécifications de correction d'épaisseur les plus adaptées » on entend donc les spécifications qui permettraient d'obtenir une couche dont le profil d'épaisseur est le plus semblable au profil représenté par la cible, si on appliquait à une couche présentant un profil d'épaisseur correspondant au profil-type une correction d'épaisseur selon lesdites spécifications de correction d'épaisseur.

Cette association par l'algorithme de configuration prend donc en compte, outre la cible, les profils-types ainsi que les recettes.

Et les nouvelles associations sont ainsi mémorisées dans la mémoire 500.

On précise qu'il est possible de mémoriser dans cette mémoire plusieurs configurations différentes, chaque configuration pouvant assigner une recette à chaque profil-type d'épaisseur, selon une association différente.

Dans ce cas, des moyens sont prévus pour permettre à un utilisateur de sélectionner la configuration désirée.

On notera que la cible 30 et les profils-types de la liste 20 sont des paramètres représentant des grandeurs similaires, c'est à dire un profil d'épaisseur selon un maillage déterminé de la surface de la couche mince.

En effet, on comprend dans ce texte le terme de « profil d'épaisseur » par une série de valeurs d'épaisseur de couche, en des points déterminés de la couche.

Et comme mentionné ci-dessus, ces points sont répartis suivant un maillage de préférence bidimensionnel, mais possiblement monodimensionnel voire ponctuel (réduit à un point), de la surface de la couche. Ce maillage sert ainsi de base pour les profils :

- mesurés lors de l'opération 1051',
- profils-types mémorisés dans la liste 20,
- cible 30 également mémorisée.

Précisons toutefois qu'il est possible de prévoir que ces trois catégories de profils soient mémorisés et exploités avec des niveaux de détail différents, dans une variante de l'invention (par exemple acquisition de mesures d'épaisseur selon un maillage très détaillé, et exploitation d'une cible définie sur
5 un sous-maillage moins détaillé – on pourra ainsi typiquement avoir une cible constituée d'une valeur unique d'épaisseur pour toute la couche).

Et il est même possible de prévoir que ces trois catégories de profils soient définies par des maillages totalement décorrés les uns des autres : en particulier, le maillage définissant le profil mesuré, et celui définissant le profil
10 de correction peuvent être décorrés, et définis indépendamment l'un de l'autre.

Dans un mode de réalisation, ces trois catégories de profils sont toutefois mémorisés et exploités avec le même niveau de détail dans le dispositif permettant de mettre en œuvre l'invention.

15 On comprend donc qu'à tout moment donné, sont mémorisés dans la mémoire 500 :

- des informations « permanentes » - qui peuvent cependant être réactualisées :
 - liste 20 de profils-types,
 - 20 ➤ bibliothèque 40 de recettes,
- ainsi qu'une cible 30 et au moins une configuration, une seule de ces configurations étant sélectionnée à tout moment.

En référence maintenant à la figure 4, on va décrire la manière dont cette configuration est exploitée pour réaliser l'opération 1052'.

25 Considérant une couche mince 201 (voir figure 5) à finaliser, on cherche à obtenir, après avoir réalisé la correction d'épaisseur 1053' selon la recette qui sera sélectionnée en 1052' suite à la mesure qui a été faite en 1051' de l'épaisseur de la couche mince, une couche mince finie dont le profil d'épaisseur soit le plus semblable possible à la cible 30 mémorisée dans la

mémoire 500.

Revenant à l'opération 1052' de déduction de recette, cette opération s'effectue selon deux niveaux.

Le premier niveau correspond à l'algorithme décrit ci-dessus – il s'agit de
5 configurer le dispositif en définissant des associations entre les profils-types et les recettes pour une cible donnée.

Cet algorithme de configuration est comme on l'a dit exécuté lors de tout changement de cible (par exemple pour traiter de manière spécifique un lot de couches minces), dans un mode entièrement automatisé de mise en œuvre de
10 l'invention.

On précise qu'en tout état de cause, même dans ce mode entièrement automatisé, une possibilité peut être laissée à un opérateur de mettre lui-même à jour la configuration mémorisée dans le dispositif.

A cet égard, l'opérateur peut établir lui-même toute configuration désirée
15 en définissant des associations spécifiques entre profils-type d'épaisseur et recettes, pour la charger dans la mémoire de la machine et la mettre en service.

Cet algorithme de configuration peut par exemple réaliser les tâches suivantes :

- pour chaque profil-type, évaluation des différences de valeurs
20 d'épaisseur entre le profil-type et le profil cible 30. Ces différences d'épaisseur correspondent alors aux corrections d'épaisseur à effectuer sur le profil-type pour obtenir un profil similaire à celui de la cible 30,
- déduction, pour chaque profil-type, d'une recette la plus appropriée pour effectuer les corrections d'épaisseur précédemment évaluées.

25 A chaque profil-type (de 21 à 27) est alors associée une recette (de 41 à 49) ; dans notre exemple purement illustratif, les associations suivantes ont été déduites :

21 et 43 ; 22 et 46 ; 23 et 42 ; 24 et 49 ; 25 et 41 ; 26 et 47 ; 27 et 44.

Un utilisateur 600 peut comme on l'a dit modifier des paramètres



mémorisés en 500, par exemple le profil cible 30, des profils-types (de 21 à 27) et/ou des recettes (de 41 à 49), et ce par l'intermédiaire d'une interface utilisateur-support mémoire (telle qu'un clavier et un écran).

Ces changements peuvent consister en des ajouts, des effacements
5 et/ou des transformations de paramètres.

Après une telle modification l'utilisateur peut déclencher une reconfiguration du dispositif – c'est à dire une exécution de l'algorithme de configuration – pour établir de nouvelles associations.

Le deuxième niveau de l'opération 1052', en référence à la figure 4,
10 concerne une sélection de recette (de 41 à 49) en fonction d'une cible 30 mémorisée et d'un profil de mesure 60 obtenu en 1051' à partir d'une couche mince 201.

Ce deuxième niveau ne s'effectue qu'une fois le dispositif configuré comme expliqué ci-dessus.

15 Cette déduction de recette se déroule en deux étapes :

- sélection 70 parmi les profils-types de la liste 20 mémorisée, d'un profil-type le plus semblable au profil mesuré 60. Ceci peut se faire suite à l'évaluation des différences des valeurs d'épaisseur entre le profil mesuré 60 et chacun des profils-types, suivant un maillage donné (par exemple
20 le maillage définissant les profils-types, ou un sous-maillage de ce maillage),
- Déduction 80 de la recette 41 à 49 associée au profil-type 21 à 27, grâce à l'association fournie par la configuration sélectionnée (on précise à cet égard que l'unité de traitement est reliée aux différents champs de la
25 mémoire 500).

Dans notre exemple, le profil-type le plus semblable au profil mesuré 60 est référencé 23, et la recette associée est donc référencée 42.

Et la recette déduite 42 comprend des paramètres aptes à commander la correction d'épaisseur adaptée au profil de mesure 60.

Pour ajuster au plus près les épaisseurs obtenues par application des recettes sélectionnées, on pourra augmenter le nombre de profils-types de la liste 20 et de recettes de la liste 40.

Il est également possible dans cette perspective d'adapter, par exemple
5 pour certains lots de couches minces, les listes de profils-types et de recettes que l'on exploite pour sélectionner une recette à partir des mesures d'épaisseur.

Dans une variante de réalisation de l'invention, les listes 20 et/ou 40 de profils-types et de recettes font ainsi l'objet d'un classement particulier, par
10 exemple selon une arborescence définissant des catégories et sous catégories (avec un nombre de niveaux désiré).

Il est dans ce cas possible de regrouper par exemple les profils-types en catégories de profils similaires, selon une arborescence de catégories, sous-catégories, etc.. dont les feuilles (le niveau le plus bas) sont des listes 20 de
15 profils-types.

On peut par exemple définir une catégorie par des caractéristiques très générales de profil-type, et retenir des caractéristiques de plus en plus détaillées pour définir les groupements de niveau inférieur dans l'arborescence.

Dans ce cas, on peut sélectionner – toujours par l'intermédiaire d'une
20 interface du dispositif – des zones de l'arborescence de profils-types dans lesquelles chercher pour réaliser la sélection 70.

On peut ainsi éviter de chercher à comparer les couches d'un certain lot avec des profils-types qui ne présenteront pas les mêmes caractéristiques générales, et ne chercher que dans les catégories contenant des profils-types
25 similaires aux profils attendus des couches que l'on mesure.

Dans ce cas, la sélection 70 se fait en autant de pas que l'arborescence comprend de niveaux – un pas de sélection initial permettant de sélectionner une catégorie de niveau le plus élevé de l'arborescence, chaque pas suivant permettant de sélectionner une sous-catégorie, sous-sous catégorie, etc.. en
30 descendant à chaque fois l'arborescence d'un niveau, jusqu'à sélectionner la



liste de profils-types adéquate, et enfin le profil-type le mieux adapté.

En tout état de cause, une configuration unique est sélectionnée pour chaque liste de profils-types susceptible d'être explorée pour la sélection d'un profil-type ; et une fois le profil-type sélectionné, c'est cette configuration de la

5 liste comprenant le profil-type qui sera utilisée pour déduire une recette.

Cette sélection en pas successifs permet de répertorier le profil mesuré

60 dans des catégories successives, de plus en plus détaillées et précises, en termes de spécifications d'épaisseur.

Elle offre ainsi l'avantage de gagner en efficacité et en rapidité lors de

10 l'étape de déduction du profil-type mémorisé le plus semblable au profil mesuré 60.

D'autres variantes peuvent également exister et concernent le même type de fonctionnement de l'opération 1052' non pas au deuxième niveau, mais au premier niveau.

15 Il est en effet possible de ventiler de manière similaire l'ensemble des profils-types en plusieurs listes 20 regroupées en une arborescence de profils-types, et/ou de ventiler l'ensemble des recettes en plusieurs listes 40 regroupées en une arborescence de recettes, pour mettre en œuvre l'algorithme de configuration.

20 Dans ce cas en effet, pour établir une configuration, l'algorithme de configuration cherchant une recette à associer à un profil-type ne cherchera pas dans toutes les recettes, mais sélectionnera d'abord des catégories de recettes en fonction des écarts d'épaisseur entre la cible et le profil-type (c'est à dire en sélectionnant une catégorie de recettes correspondant le mieux possible à ces

25 écarts).

Ici encore, l'arborescence des recettes est définie par des niveaux de détail de plus en plus fins en descendant l'arborescence (c'est à dire par exemple en définissant les catégories de haut niveau par peu de paramètres de correction d'épaisseur, et en aboutissant en bas d'arborescence à une définition

30 plus complète de la recette).

Et il est également possible d'établir pour la configuration un lien entre un niveau donné d'une arborescence de profils-types (« niveau de départ ») et une arborescence de recettes (« niveau d'arrivée ») : dans ce cas, pour chaque profil-type rattaché à une catégorie donnée de ce niveau de départ, il existe une
5 catégorie du niveau d'arrivée des recettes.

Et lors de la configuration, toute recherche d'une recette pour un profil-type de ce niveau de départ sera automatiquement dirigée vers ladite catégorie de niveau d'arrivée (la recherche se poursuivant ensuite en descendant l'arborescence des recettes).

10 On peut aussi lors de la configuration associer à une liste 20 de profils-types la même recette, ou la même liste 40 de recettes – ou de manière générale le même regroupement à un niveau quelconque de l'arborescence des recettes.

On peut faire de même pour toute liste 20 de profils-types – ou de
15 manière générale pour tout regroupement à un niveau quelconque de l'arborescence des profils-types.

Il est également possible de définir une arborescence des recettes non pas par niveaux de détails successifs, mais par paramètres de recettes.

On peut ainsi définir par exemple :

- 20
- une première catégorie du niveau le plus haut dans l'arborescence des recettes, les recettes de cette première catégorie de niveau le plus haut définissant une spécification de correction d'épaisseur uniforme pour toute la surface de la couche,
 - et d'autres catégories de plus haut niveau, selon des paramètres globaux
25 de répartition des spécifications de correction d'épaisseur sur cette surface.

Par exemple :

- réduction d'épaisseur plus (ou au contraire moins) importante dans une région centrale de la couche,
- réduction d'épaisseur plus (ou au contraire moins) importante dans un

secteur angulaire donné de la couche,

➤ etc...

On pourra ainsi lors du choix de la recette à appliquer à une couche dont on vient de mesurer l'épaisseur, naviguer dans cette arborescence de recettes
5 en fonction des principales caractéristiques de la cartographie d'épaisseur mesurée sur la couche.

Par exemple, dans le cas d'une couche présentant un profil d'épaisseur concave, le système associera automatiquement un profil type d'épaisseur concave correspondant à la couche mesurée. Et, poursuivant cet exemple, si la
10 cible d'épaisseur est une cible « plate », c'est-à-dire correspondant à une épaisseur constante de la couche, il conviendra d'appliquer une recette permettant de rattraper cette concavité constatée.

Dans ce cas, l'algorithme de configuration permettant de sélectionner une recette dans la bibliothèque va explorer une catégorie de haut niveau
15 correspondant à des recettes « convexes » ou « bombées ».

L'exemple qui vient d'être mentionné correspond ainsi à une correction d'épaisseur permettant d'obtenir une uniformité d'épaisseur intracouche.

Et les considérations ci-dessus à, propos de l'établissement de liens entre les profils-types et les recettes demeurent applicables, quelles que soient
20 les arborescences retenues.

Dans tous les cas, les deux niveaux décrits ci-dessus – configuration et sélection d'une recette pour chaque couche mesurée – correspondent à l'opération 1052'.

Dans un mode préférentiel, l'opération de déduction 1052' est mise en
25 œuvre par un dispositif intégrant des composants électroniques aptes à mémoriser et à exécuter au moins un programme logique, lui-même apte à mettre en oeuvre au moins une partie de l'opération de déduction ; il peut s'agir, par exemple, de l'exécution de programmes binaires par un ordinateur.

On précise que l'opération de déduction de spécifications de correction

d'épaisseur 1052' peut également être réalisée différemment des modes préférés décrits ci-dessus.

Il est ainsi possible de mettre en œuvre tout moyen pour élaborer des spécifications de correction, à partir d'une cible mémorisée et d'une mesure de
5 profil acquise.

Dans un mode de réalisation particulièrement simple, il est ainsi possible de faire calculer, pour chaque couche mince dont on a mesuré l'épaisseur, des spécifications déduites directement des écarts d'épaisseur entre le profil de la cible et le profil mesuré.

10 Et dans un mode de réalisation simplifié de l'invention, il est également possible comme mentionné ci-dessus que la déduction des spécifications de correction d'épaisseur soit simplement réalisée par un opérateur, en fonction des mesures d'épaisseur constatées.

Dans ce cas, l'opérateur, après avoir lui-même déduit les spécifications
15 de correction d'épaisseur à appliquer à une couche qui vient d'être mesurée, renseigne les moyens de correction d'épaisseur avec ces spécifications.

Et toujours comme mentionné ci-dessus, il est également possible que l'opérateur ne renseigne ces spécifications de correction d'épaisseur qu'à l'occasion d'un changement de cible, dans le cas où les couches d'un même lot
20 – ou même les couches de plusieurs lots consécutifs – ont préalablement subi des étapes de fabrication dans des conditions similaires et doivent respecter en fin de processus une même cible d'épaisseur (par exemple une cible constituée simplement d'une valeur d'épaisseur moyenne, ce qui implique une épaisseur la plus constante possible de la couche).

Correction d'épaisseur

L'opération 1053' comprend au moins une correction d'épaisseur de la



couche selon les spécifications de correction d'épaisseur précédemment déduites en 1052'.

L'exemple qui va maintenant être détaillé ci-dessous à propos de la technique de correction d'épaisseur concerne une technique de correction
5 d'épaisseur par oxydation sacrificielle.

Toutefois, il est possible selon l'invention de mettre en œuvre d'autres types de technique pour corriger l'épaisseur des couches.

On pourra ainsi par exemple mettre en œuvre des techniques de type :

- gravure de type plasma, de préférence modulée localement,
- 10 • polissage de la couche.

De manière générale, on préférera adopter une technique permettant de corriger l'épaisseur de chaque couche en traitant simultanément toute la surface de la couche, mais en conservant la possibilité de différencier localement la correction d'épaisseur selon l'endroit de la surface de la couche.

15 On peut donc dans un exemple qui correspond à une variante particulière de l'invention traiter l'épaisseur des couches par oxydation sacrificielle, en réalisant une étape de formation d'une couche d'oxyde à la surface de la couche, éventuellement une étape de recuit, et une étape de désoxydation.

20 Dans l'exemple d'une tranche 200 comprenant une couche mince de semi-conducteur 201 sur un substrat support 202 comme représenté sur la figure 5, l'oxydation sacrificielle est mise en œuvre pour réduire sélectivement l'épaisseur de la zone superficielle 203 se trouvant à la surface de la couche, cette zone offrant une trop grande inhomogénéité d'épaisseur de couche.

25 On précise que par « sélectivement » on entend la caractéristique consistant à attaquer par l'oxydation de manière différenciée différentes régions de la surface de la zone 203.

Plus précisément, on précise que « sélectivement » ne correspond pas à un traitement « binaire » dans lequel on oxyderait soit totalement, soit pas du

tout, certaines régions de la couche.

Il s'agit au contraire d'adapter localement à volonté l'importance de l'oxydation, selon l'endroit de la couche considéré.

En effet, il est possible en mettant en œuvre une technique d'oxydation sacrificielle d'ajuster les modifications d'épaisseur en différents endroits de la surface de la couche.

L'effet de la technique d'oxydation sacrificielle est illustré sur les figures 5a à 5c.

La figure 5a représente ainsi une couche de semi-conducteur 201 (par exemple en silicium) sur un substrat 202.

La couche 201 présente une région superficielle 203 qui définit une épaisseur non uniforme (dans l'exemple simplifié de la figure 5a, la surface de la région 203 présente une pente qui a été exagérée).

En référence à la figure 5b, la couche 201 est oxydée par traitement thermique pour former une couche d'oxyde 204. Cette couche d'oxyde 204 se développe au voisinage de la surface de la couche 201 au niveau de la zone 203 (dont la limite est représentée en traits interrompus sur la figure 5b).

Au cours du traitement thermique, l'interface entre l'oxyde et le silicium progresse en profondeur dans le silicium, en définissant une frontière 2014 entre la couche d'oxyde superficielle et la couche de silicium 201 dont la pente se rapproche d'une direction parallèle à la direction générale de l'interface entre la couche 201 et le substrat 202.

Plus précisément, la position de cette frontière 2014 est définie par l'intensité locale de l'oxydation sacrificielle.

Et du fait qu'on contrôle (comme cela sera expliqué plus en détails plus loin dans ce texte) cette intensité locale d'oxydation sacrificielle, on contrôle par conséquence localement la position de la frontière 2014 en tout point de la couche.

Dans le cas de la représentation simplifiée de la figure 5b, on peut considérer en première approche que cette frontière a une position



sensiblement symétrique à celle de la surface de la couche d'oxyde créée, par rapport à la position de la surface de la région 203 (région qui a été « absorbée » dans la couche d'oxyde 204).

Dans une variante qui correspond à des enseignements du brevet FR 2 777 115 (voir en particulier l'exemple 2), une étape additionnelle de recuit du substrat est ajoutée pour permettre de guérir la couche 201 des irrégularités de surface engendrées au cours de l'oxydation et au cours des étapes précédentes du procédé d'élaboration de couche mince.

Comme expliqué dans ce brevet FR 2 777 115 (voir page 11 ligne 30 jusqu'à la fin de la description), on peut en particulier traiter des structures de type SOI.

En référence à la figure 5c, une étape de désoxydation suit le recuit.

La couche d'oxyde 204 est lors de cette étape généralement consommée par voie chimique. A titre d'exemple, pour enlever une épaisseur de SiO_2 de l'ordre de 50 à 200 Angströms, la tranche 200 est plongée dans un bain d'acide fluorhydrique à 10 ou 20 %, pendant environ 5 à 30 secondes.

Au final, on obtient une couche mince 201, figure 5c, ayant une épaisseur plus uniforme (et moins importante) que la couche mince initiale 201, de la figure 5a.

Le procédé d'oxydation sacrificielle décrit ci-dessus n'est qu'une variante des procédés exposés dans le document FR 2 777 115 ; la présente invention n'est pas limitative à cette variante et s'étend à tous les autres procédés d'oxydation sacrificielle.

Les paramètres principaux des techniques de traitement thermique d'oxydation sont la température, la durée d'oxydation, et la pression partielle d'oxygène dans l'atmosphère d'oxydation.

Ces paramètres peuvent être bien contrôlés, ce qui confère à cette application du procédé une bonne reproductibilité.

Ce procédé est aussi souple d'utilisation et compatible avec l'ensemble des procédures habituelles de traitement de couches minces ou de tranches pour la fabrication de composants pour la micro-électronique.

Les figures 6 à 10 présentent un traitement particulier de couche mince par oxydation sacrificielle au moyen d'une technique d'oxydation thermique rapide (ou RTO, acronyme anglo-saxon de Rapid Thermal Oxidation).

Le dispositif de traitement de couches minces par oxydation sacrificielle qui va servir de base à cette description est un dispositif du type RTP XE Centura, de la société Applied Materials®.

10 Ce dispositif comprend notamment une chambre d'oxydation 400 apte à contenir au moins une couche mince de semi-conducteur ou une tranche comprenant une couche mince de semi-conducteur.

La couche mince ou la tranche est supportée, à l'intérieur de la chambre d'oxydation, par un plateau annulaire 403 plat, généralement en carbure de silicium.

15 Au-dessus de la couche mince se trouve un système de chauffage comprenant plusieurs lampes 401, chacune étant généralement placée à l'intérieur de tubes légers.

Ces lampes 401 sont préférentiellement de type halogène.

20 Ces lampes 401 sont avantageusement disposées de sorte à recouvrir la surface de la couche mince.

Du fait de la très forte chaleur dégagée par ce système de chauffage (de l'ordre de 1000°C), il est recommandé d'installer un circuit de refroidissement 407 dans la paroi de la chambre d'oxydation 400, afin d'évacuer la chaleur et d'éviter ainsi d'éventuelles brûlures aux parois externes de la chambre 400.

25 Une fine fenêtre 402, généralement en quartz, sépare les lampes 401 de la chambre des gaz 407 oxydants, la chambre des gaz 407 étant l'espace libre situé au-dessus de la couche mince (voir figure 7 et figure 8).

Au moins deux ouvertures 409 et 410, généralement en vis à vis, sont pratiquées dans la paroi de la chambre d'oxydation 400 au niveau de la

chambre des gaz 407, chacune d'entre elles étant apte à être reliée hermétiquement à un système de pompage, afin de permettre l'entrée 301 et la sortie 302 respectives des gaz oxydants de la chambre des gaz 407.

Un cylindre 406, préférentiellement creux et préférentiellement en quartz, 5 situé en dessous du support 403 et solidaire de celui-ci est apte à opérer une rotation autour de l'axe du cylindre par rapport à la chambre d'oxydation 400.

Le cylindre 406 permet ainsi de faire tourner la couche mince sous les lampes 401, et d'obtenir un traitement thermique aussi uniforme que possible appliqué à toute la couche en permettant de s'affranchir des effets de toute 10 inhomogénéité locale thermique.

Ceci est particulièrement avantageux lorsqu'on désire appliquer à une couche une recette homogène sur la surface de la couche.

Et de manière générale, la configuration avec un support 403 pouvant être mis en rotation est bien adaptée lorsque l'on souhaite réaliser une 15 correction d'épaisseur avec une symétrie par rapport à l'axe de rotation du support.

Ceci peut être désiré en particulier lorsque l'on traite des lots de couches ayant préalablement subi des étapes d'élaboration et de traitement qui avaient elles-mêmes pour effet de modifier de manière symétrique les propriétés de la 20 couche.

Il est cependant également possible en variante d'adopter un support 403 fixe.

Un système de mesure en température est également installé dans la chambre, généralement placé sous la couche mince et/ou la tranche.

25 Il comprend préférentiellement un plateau de réflectance 405 apte à amplifier les informations de rayonnements thermiques pour que des capteurs 404 capturent les informations thermiques et les transmettent à une unité de contrôle reliée à l'unité de traitement.

Les capteurs 404 sont disposés pour mesurer le profil de température 30 des gaz oxydants à proximité de la surface de la couche mince.

Les capteurs 404 sont préférentiellement des fibres optiques, et sont donc destinés à transmettre l'information optique des rayons thermiques, prélevés à proximité du plateau de réflectance 405, à une unité de contrôle.

En référence à la figure 7, les gaz entrés en 301 se retrouvent pendant
5 une durée déterminée dans une chambre des gaz 407 portée à une température de consigne. La sortie des gaz se fait en 302.

Comme expliqué ci-dessus, une fois que la nature du gaz, la teneur en oxygène de l'atmosphère et la pression sont fixées, ce sont ces paramètres
10 durée de temps et température qui vont déterminer en temps réel l'épaisseur moyenne d'oxyde formée dans une couche mince 201, comme l'illustre la figure 12.

Cette figure montre en effet les progressions en épaisseur (en ordonnée), de couches minces pour différentes durées d'oxydation (en abscisse) – et ce pour différentes températures d'oxydation correspondant aux différentes
15 courbes.

Plus la température d'oxydation est élevée, plus l'épaisseur moyenne de couche oxydée est élevée, et ce pour une même durée d'oxydation fixée à une certaine valeur.

Plus la durée d'oxydation est grande, plus l'épaisseur moyenne de
20 couche oxydée est élevée, et ce pour une température fixée à une certaine valeur.

On assure par ailleurs le contrôle de la température, en régulant individuellement l'alimentation des lampes 401 (ou de groupes de lampes).

L'ajustement électrique individualisé pour chaque lampe permet ainsi
25 d'établir un profil de température différencié et prédéterminé sur toute la surface de la couche mince.

Ceci est illustré sur la figure 9, pour trois types de taille de couches minces 206, 207 et 208, chacune en forme de disque.

Dans l'exemple particulier illustré ici, les lampes sont classées en douze
30 catégories, numérotées de 1 à 12 allant des lampes surplombant la zone



centrale vers les lampes surplombant les zones périphériques des couches 206, 207 et 208. Chaque numéro de lampe correspond, dans cet exemple, à une température de lampe.

On précise que le nombre de catégories de lampes peut être adapté en
5 fonction des besoins : on augmentera le nombre si on désire différencier finement la correction d'épaisseur appliquée aux différents endroits de la couche.

La température obtenue en un point de la surface de la couche dépendant d'abord de la lampe la plus proche mais aussi des lampes voisines,
10 la zone centrale de la couche sera donc plus chaude que sa zone périphérique dans le cas d'une alimentation uniforme de toutes les lampes (c'est à dire si tous les numéros de lampes sont les mêmes).

Si on souhaite une température uniforme (et donc une oxydation uniforme) sur toute la surface de la couche 206, 207 ou 208, on alimente les
15 lampes centrales de manière à ce que celles-ci soient moins chaudes que les lampes périphériques.

Si on souhaite au contraire obtenir des températures différenciées (et donc une oxydation différenciée) sur la surface de la couche 206, 207 ou 208, il suffit d'adapter les alimentations de chaque lampe dans le but d'obtenir le profil
20 en température souhaité.

Et cette différenciation sélective des alimentations de chaque lampe découle directement des commandes correspondant à la recette sélectionnée, commandes qui ont été transmises au dispositif de correction d'épaisseur par l'unité de traitement.

25 On précise par ailleurs qu'il est possible d'étalonner le dispositif de correction d'épaisseur de manière à ce que des recettes (élaborées automatiquement par l'unité de traitement ou bien simplement par un opérateur) dont les caractéristiques sont transmises sous forme de commandes au dispositif de correction d'épaisseur, produisent l'effet souhaité en terme de
30 correction d'épaisseur.

On pourra réaliser un tel étalonnage en observant l'effet de consigne de correction d'épaisseur (recettes), sur la surface de couches. On pourra même faire suivre l'opération de correction d'épaisseur d'une dernière mesure de couche, afin de détecter d'éventuelles dérives de la correction d'épaisseur par rapport à la recette spécifiée.

Dans ce cas, il est possible de prévoir une boucle de régulation sur le dispositif de correction d'épaisseur pour adapter l'alimentation des différentes catégories de lampes et remédier à ces dérives en temps quasi-réel.

On précise par ailleurs que les principaux paramètres caractérisant l'oxydation sacrificielle peuvent être suivis et pris en compte par l'unité de traitement, qui gère le dispositif de correction.

A ces fins, l'unité de traitement est reliée aux différents capteurs qui permettent de caractériser le déroulement des opérations d'oxydation sacrificielle (en particulier temps et différentes sondes de températures).

Les opérations d'ajustement en température peuvent en effet être facilitées par des mesures en température au moyen de capteurs 404, référencés ici P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 et P8, au voisinage de la couche.

La durée d'oxydation sacrificielle est également définie dans la commande transmise par l'unité de traitement au dispositif de correction d'épaisseur suite à la sélection d'une recette.

Cette durée d'oxydation est déterminée grâce en particulier à des valeurs de référence préétablies à partir de liste de mesures précédemment effectuées, et mémorisées dans l'unité de traitement.

Ces mesures précédemment effectuées comprennent :

- des mesures de durée de séquence machine connue (par exemple la durée entre le temps d'entrée 301 et le temps de sortie 302 de gaz, ou bien la durée entre le temps d'entrée et le temps de sortie d'une couche mince de la chambre d'oxydation, ou bien la durée entre le temps de début et le temps de fin de chauffage, etc.),



- et des mesures d'épaisseur d'oxyde pour un certain nombre de couches post-oxydées dans des conditions d'oxydation prédéterminées.

A partir des comparaisons de ces deux types de mesures, et de la recette sélectionnée, l'unité de traitement déduit des valeurs de référence pour la
5 détermination d'une durée d'oxydation de couches élaborées dans ces mêmes conditions d'oxydation prédéterminées.

Ajoutons que les paramètres principaux influençant la durée d'oxydation (contrôle de la composition chimique du gaz oxydant durant l'oxydation, contrôle en température, contrôle en pression, etc.) sont également contrôlés.

10 A cet égard, une variante du dispositif représenté figure 8 illustre un moyen de contrôle supplémentaire de la pression dans la chambre des gaz 407.

Le schéma de la figure 8 représente en effet une chambre d'oxydation 400 comprenant une chambre supplémentaire de pressurisation 408 reliée à au
15 moins une pompe à vide et permettant de créer une pression réduite dans la chambre des gaz 407.

Par ce moyen, pour des pressions réduites, on peut influencer la vitesse d'oxydation des couches, et donc autoriser un meilleur contrôle de l'épaisseur des couches.

20 Les pressions utilisées sont typiquement au-dessus de quelques torrs, et donc de valeurs plus grandes que 0,01 atmosphère.

L'oxydation thermique peut toutefois être réalisée aussi sous pression atmosphérique, voire à une pression supérieure.

En ce qui concerne le paramètre de composition chimique des gaz
25 oxydants, il est d'abord habituel d'avoir, avant toute entrée 301 de gaz, une atmosphère rendue la plus inerte et la moins oxydante possible au moyen par exemple de gaz inerte ou d'hydrogène.

La formation d'une couche d'oxyde de surface peut être généralement réalisée par voie sèche, ou par voie humide.

Par voie sèche, la formation de la couche d'oxyde de surface est produite sous oxygène gazeux.

Par voie humide, la formation de la couche d'oxyde de surface est produite par l'intermédiaire de vapeur d'eau.

- 5 En ce qui concerne la voie humide, une technique préférentielle est celle concernant un mélange gazeux en entrée 301 comportant du dioxygène et de l'hydrogène.

En pratique, tous ces paramètres (température, durée, pression, composition des gaz) sont contrôlés, permettant ainsi d'atteindre une
10 reproductibilité fiable des oxydations pour des variations d'épaisseur d'oxyde qui peuvent osciller autour de 10 Angströms, comme le montre par exemple la figure 14 où des épaisseurs d'oxyde (en ordonnée) sont comparées pour 700 couches (en abscisse) élaborées dans les mêmes conditions d'élaboration.

Ces paramètres sont aussi faciles à ajuster, rendant un tel procédé bien
15 plus souple d'utilisation et plus homogène que l'ensemble des procédures habituelles de traitement de couches minces et/ou de tranches pour la fabrication de composants pour la micro-électronique.

La figure 10 illustre un procédé de fonctionnement d'une chambre d'oxydation thermique rapide.

- 20 On précise que dans la version la plus complète du dispositif selon l'invention (qui comprend en particulier une unité de traitement), les moyens matériels évoqués pour cette oxydation thermique rapide sont reliés à l'unité de traitement, et sont commandés par elle.

Une unité de contrôle 502 en température ajuste un profil 503 préétabli
25 de température dans le temps en fonction des mesures en température 501 reçues des capteurs 404 au niveau d'une couche mince 201, et alimente les lampes 401 conformément au profil 503 choisi.

Ce dispositif permet ainsi d'avoir un contrôle précis et aisé sur le déroulement de l'oxydation, et donc sur les valeurs d'épaisseur de la couche
30 201.

L'unité de contrôle 502 peut aussi avantageusement prendre en compte des spécifications des paramètres composition des gaz, pression dans la chambre des gaz, arrivée des gaz, cadence de passage des couches à l'intérieur de la chambre, etc.

- 5 De la sorte, la mise en œuvre d'une oxydation sacrificielle par laquelle on effectue un retrait d'épaisseur de couche est plus rapide que les techniques de l'art antérieur, étant donné que cette technique d'oxydation sacrificielle se fait simultanément sur toute la couche (et non de façon locale).

- Des variantes d'un tel dispositif concernant des chambres d'oxydation
10 pouvant contenir plusieurs couches minces, ou des associations de plusieurs chambres d'oxydation, pour augmenter encore la cadence des couches dans la chaîne de leur élaboration.

- Le choix du dispositif de correction d'épaisseur mis en œuvre par le procédé de la présente invention ne se limite pas à ce dispositif 400 d'oxydation
15 thermique rapide mais à tous les autres dispositifs d'oxydation thermique.

De manière générale, on obtient grâce à la technique d'oxydation sacrificielle une précision de correction bien supérieure à ce qui est envisageable avec des techniques connues.

- Une application du présent procédé consiste en un retrait uniforme de
20 matière sur la surface de la couche et pouvant atteindre plusieurs centaines d'Angströms.

Ceci est atteint en sélectionnant une recette comprenant une seule valeur de correction d'épaisseur, ce qui permettra de réduire de façon uniforme l'épaisseur de la couche à corriger.

- 25 Et le dispositif d'oxydation règlera dans ce cas la température dans la chambre d'oxydation, en jouant en particulier sur l'alimentation électrique des lampes 401 et sur la durée d'oxydation afin d'obtenir une température uniforme au niveau de toute la surface de la couche, et donc une oxydation uniforme.

Une autre application consiste à effectuer un retrait de matière différencié sélectivement sur la surface de la couche, par exemple pour ajuster une uniformité intracouche.

5 Dans le cas particulier où on essaie ainsi d'atteindre une uniformité intracouche en épaisseur de la couche, il peut être en effet nécessaire de pratiquer un rattrapage de certaines zones inégales, telle une symétrie cylindrique convexe, concave et apparue lors de l'élaboration de la couche, ou bien telles des pentes « à gauche » ou « à droite », etc.

10 Un tel retrait différencié de matière peut être mis en œuvre par un procédé d'oxydation sacrificielle, en particulier en établissant localement au niveau de la surface de la couche une température d'oxydation spécifique, et donc une épaisseur d'oxyde spécifique, en sélectionnant une recette adaptée, ce qui entraînera l'envoi d'une commande correspondante au dispositif d'oxydation sacrificielle:

15 Et reprenant le cas de la chambre d'oxydation 400, une telle commande provoquera l'alimentation sélective des lampes 401 nécessaires pour réaliser les corrections désirées dans les zones choisies.

On précise que par « alimentation sélective » des lampes 401, on entend une alimentation non pas binaire, mais pouvant évoluer de manière continue et
20 progressive entre différentes intensités d'alimentation, de manière individuellement adaptée pour chacun lampe.

Il est également possible de combiner des recettes, pour traiter une même couche.

On peut ainsi en particulier mettre en œuvre une correction (par exemple
25 importante) d'épaisseur de manière uniforme sur la couche, puis une correction différenciée plus fine et susceptible de rattraper les inhomogénéités locales d'épaisseur, le rattrapage local pouvant être mis en œuvre par oxydation sacrificielle différenciée.

Par ce procédé d'élaboration de couche intégrant des opérations de
30 correction d'épaisseur, le traitement de couche par oxydation sacrificielle est



adapté aux épaisseurs actuelles de couches minces.

Les paramètres temps et température de l'oxydation, facilement ajustables, peuvent définir la quantité de matière à retirer et donc autorisent une maîtrise de la technique de sorte à obtenir une quantité de matière retirée
5 pouvant varier de manière contrôlée entre quelques dizaines d'Angströms et quelques milliers d'Angströms, sans pour autant créer de défauts cristallins notables, et conduisent donc à des applications sur des couches très minces.

Ces derniers points mènent en pratique à des possibilités d'application du procédé de la présente invention sur des couches minces de semi-
10 conducteur d'épaisseur moyenne bien inférieures à $1\text{ }\mu\text{m}$.

Un autre aspect de l'invention concerne le fait que les couches minces sont généralement élaborées par lots.

Selon cet aspect de l'invention, on définit, pour toutes les couches d'un lot, un profil unique d'épaisseur cible (c'est la « cible » 30 qui est commune aux
15 couches du lot).

Les spécifications respectives de correction d'épaisseur de chaque couche du lot sont alors individualisées de manière à ce que chaque couche du lot ait, une fois la correction d'épaisseur effectuée, un profil d'épaisseur final de couche le plus proche possible de la cible.

20 Les corrections d'épaisseur peuvent être uniformes, différenciées ou bien uniformes et différenciées, comme cela a été décrit ci-dessus.

Ce procédé concernant des couches de lot peut aussi s'appliquer à un lot organisé en une succession de couches, et pour lequel on mesure (1051') l'épaisseur moyenne d'une couche du lot pendant qu'on corrige (1053')
25 l'épaisseur de la couche précédente du même lot (après avoir mesuré l'épaisseur de cette dernière couche).

Un résultat global de l'utilisation de ce type de procédé conforme à l'invention est présenté figure 13, qui comprend trois graphes 13a, 13b et 13c.

Ces trois graphes représentent des histogrammes de répartition d'épaisseur de couches d'un même lot (par souci de simplification, le lot comprend ici trois couches).

5 Chaque courbe d'histogramme correspond ainsi à une couche, en représentant le nombre N de points de la surface de la couche ayant une épaisseur donnée (épaisseur en abscisse, N en ordonnée).

Chaque couche a ainsi une épaisseur qui peut typiquement être répartie selon une gaussienne (les points auxquels l'épaisseur est déterminée étant définis par un maillage de la surface de la couche).

10 Et en traits pointillés verticaux est représentée une épaisseur moyenne de chaque couche.

Le graphe 13a montre ainsi une première répartition d'épaisseurs, pour les trois couches du lot. Chacune de ces trois couches a une répartition d'épaisseur, autour d'une épaisseur moyenne.

15 Le graphe 13b correspond aux mêmes couches, après un traitement par oxydation sacrificielle visant à homogénéiser les épaisseurs moyennes des couches.

On a à cet effet adopté une configuration dans laquelle les recettes sélectionnées pour chaque couche sont individualisées, en fonction de la
20 mesure de la couche, et dans la perspective d'atteindre une cible commune.

Ceci se traduit par un resserrement des épaisseurs moyennes des couches du lot (meilleure uniformité intercouches).

Il est également possible de considérer a priori que les couches de chaque lot présentent des profils d'épaisseur similaires, à des tolérances
25 données. Ceci sera vrai en particulier lorsque les couches d'un même lot ont préalablement subi les mêmes étapes de fabrication dans les mêmes conditions.

Dans ce cas, on pourra ne mesurer que certaines couches du lot (voire une seule), et non pas toutes les couches du lot. En fonction de cette ou de ces
30 mesure(s) d'épaisseur, on déduira automatiquement une recette unique à

appliquer à toutes les couches du lot en ce qui concerne la correction d'épaisseur.

Un tel traitement, dont le résultat n'est pas représenté sur les figures, aboutirait à un décalage des valeurs d'épaisseur moyenne des couches du lot, sans resserrer ces valeurs (décalage vers des valeurs plus faibles d'épaisseurs moyennes, du fait de la correction d'épaisseur).

Enfin, le dispositif particulier de correction d'épaisseur décrit plus haut (du type RTP XE Centura™) ne constitue qu'un exemple non limitatif, particulièrement adapté à la correction d'épaisseur d'une seule couche à la fois.

Il est en effet possible de mettre en œuvre selon l'invention tout dispositif de correction d'épaisseur de la surface d'une couche.

En particulier, de tels dispositifs peuvent avantageusement permettre de corriger l'épaisseur de couche de manière sélective.

On rappelle que par « sélective » on entend la faculté d'attaquer de manière différenciée différentes régions de la surface de la couche.

Et en corrigeant de manière sélective et individualisée l'épaisseur de chaque couche (ce qui nécessite une mesure de chaque couche dont on désire corriger l'épaisseur), on peut resserrer l'histogramme de répartition d'épaisseur de chaque couche du lot, en plus de rapprocher les valeurs d'épaisseur moyenne des couches.

Ceci est illustré sur le graphe 13c.

On pourra ainsi par exemple traiter des lots entiers de couches, dans des fours à tube horizontaux ou verticaux (dans ce dernier cas on parlera également de « cloches »).

De tels fours de recuit sont connus dans l'état de la technique. Ils permettent de traiter thermiquement des lots entiers de couches. Les couches sont alignées les unes à la suite des autres par exemple dans des nacelles en quartz munies d'encoches parallèles pour recevoir les couches.

Et il est possible d'ajuster les caractéristiques du traitement thermique appliqué par le four, pour appliquer à la surface de chaque couche du lot une correction d'épaisseur sélective selon les régions de la couche.

Pour ce faire, on pourra jouer en particulier sur la composition du
5 mélange gazeux à l'intérieur du four, et plus précisément sur la composition du mélange gazeux circulant dans les différentes parties du four.

Il est en effet possible de prévoir que dans certaines régions du four le mélange soit plus ou moins oxydant. Ceci peut être obtenu par une circulation locale d'un mélange gazeux spécifique.

10 Ainsi, dans le cas où on veut traiter toutes les plaques d'un lot de la même manière,, toutes les dispositions visant à produire localement des conditions particulières à l'intérieur du four s'appliqueront de la même manière à toutes les couches du lot.

On pourra également jouer sur la présence de zones chaudes à
15 l'intérieur du four.

Et ici encore, la présence de ces zones chaudes peut être définie pour avoir la même influence sur toutes les couches du lot.

On pourra par exemple de la sorte prévoir que l'oxydation sacrificielle attaque davantage les couches dans leur région périphérique que dans leur
20 région centrale, ce qui correspond à une recette convexe.

Il est possible de jouer sur les flux de gaz dans le four, pour obtenir de telles zones chaudes.

Et il est également possible de gérer les inhomogénéités de chaleur dans le four, de manière contrôlée, pour différencier au contraire le traitement
25 thermique appliqué aux différentes couches d'un lot.

REVENDEICATIONS

1. Procédé de correction de l'épaisseur d'une couche mince de matériau
5 semiconducteur, comprenant les opérations suivantes :
 - acquisition d'au moins une mesure d'épaisseur de la couche,
 - détermination de spécifications de correction d'épaisseur à appliquer à la
couche, en fonction de(s) mesure(s) d'épaisseur acquise(s),
 - correction de l'épaisseur de la couche selon lesdites spécifications de
10 correction,caractérisé en ce que la détermination des spécifications de correction
comprend :
 - l'établissement d'un profil d'épaisseur de la couche, à partir des mesures
d'épaisseur acquises,
 - 15 • la comparaison dudit profil avec des profils-types mémorisés, chaque
profil-type étant mémorisé en association avec des spécifications de
correction d'épaisseur (ou recettes) respectives, et
 - la sélection d'un profil-type mémorisé, pour associer à la couche dont on
souhaite corriger l'épaisseur, les spécifications de correction d'épaisseur
20 mémorisées en association avec le profil-type choisi
2. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le
procédé comprend une configuration permettant d'établir des associations
entre les profils-types mémorisés et les recettes.
25
3. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ladite
configuration est réalisée par un algorithme dont une donnée d'entrée est
une spécification-cible de profil d'épaisseur (ou « cible ») établie pour la
fabrication de couches.

4. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les mesures d'épaisseurs, les profils-types et la cible sont définis selon des maillages identiques.
5. Procédé selon l'une des deux revendications précédentes, caractérisé en ce que à chaque changement de cible, l'algorithme de configuration est automatiquement réactivé pour établir une nouvelle configuration définissant des correspondances entre les profils-types et les recettes.
- 10 6. Procédé selon l'une des quatre revendications précédentes, caractérisé en ce que le procédé comprend la mémorisation d'au moins une configuration.
- 15 7. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le procédé comprend la mémorisation de plusieurs configurations, ainsi que la sélection d'une configuration désirée.
- 20 8. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les profils-types et/ou les recettes font l'objet d'un classement selon une arborescence définissant des catégories et sous catégories avec un nombre de niveaux désiré.
- 25 9. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que on peut sélectionner des zones de l'arborescence de profils-types dans lesquelles chercher pour réaliser la sélection d'un profil-type.
- 30 10. Procédé selon l'une des deux revendications précédentes, caractérisé en ce que l'arborescence des recettes est définie par des niveaux de détail de plus en plus fins en descendant l'arborescence.



11. Procédé selon la revendication précédente prise en combinaison avec la revendication 3, caractérisé en ce que pour établir une configuration, l'algorithme de configuration cherchant une recette à associer à un profil-type ne cherchera pas dans toutes les recettes, mais sélectionnera d'abord des catégories de recettes en fonction des écarts d'épaisseur entre la cible et le profil-type.
12. Procédé selon l'une des quatre revendications précédentes prise en combinaison avec la revendication 3, caractérisé en ce que on établit pour la configuration un lien entre un niveau donné d'une arborescence de profils-types (« niveau de départ ») et un niveau donné d'une arborescence de recettes (« niveau d'arrivée »), de sorte que pour chaque profil-type rattaché à une catégorie donnée de ce niveau de départ, il existe une catégorie du niveau d'arrivée des recettes, et lors de la configuration, toute recherche d'une recette pour un profil-type de ce niveau de départ sera automatiquement dirigée vers ladite catégorie de niveau d'arrivée, la recherche se poursuivant ensuite en descendant l'arborescence des recettes.
13. Procédé selon l'une des deux revendications précédentes, caractérisé en ce que l'arborescence des recettes est définie par paramètres de recettes.
14. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que dans l'arborescence des recettes les catégories de plus haut niveau de recettes comprennent :
- une première catégorie de plus haut niveau de recettes qui définissent une spécification de correction d'épaisseur uniforme pour toute la surface de la couche,
 - et d'autres catégories de plus haut niveau, selon des paramètres

globaux de répartition des spécifications de correction d'épaisseur sur cette surface.

15. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que
5 la correction d'épaisseur est appliquée simultanément sur toute la surface d'une couche, avec possibilité de différencier ladite correction selon l'endroit de la surface de la couche.
16. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que
10 la correction de l'épaisseur de la couche fait intervenir une oxydation sacrificielle.
17. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que
15 les couches sont traitées par lots, l'épaisseur d'une couche d'un lot étant mesurée tandis que l'épaisseur d'une couche précédant ladite couche mesurée dans le lot avec un pas donné est corrigée.
18. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les
20 couches d'un même lot partageant une même cible d'épaisseur finale, la sélection de recette pour chaque couche est individualisée de manière à obtenir pour le lot, une fois la correction d'épaisseur effectuée, une épaisseur moyenne de couche la plus proche de la cible commune.
19. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que
25 des recettes correspondent à une modification d'épaisseur uniforme sur toute la couche.
20. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que
30 des recettes correspondent à une modification d'épaisseur différenciée sur la surface de la couche.

21. Dispositif de mise en œuvre d'un procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif comprend :

- des moyens de mesure d'épaisseur,
- 5 • des moyens de correction d'épaisseur,
- une unité de traitement, associée à des moyens de mémorisation de spécifications de correction d'épaisseur, et reliée aux moyens de mesure d'épaisseur pour en recevoir des mesures réalisées sur les couches ainsi qu'aux moyens de correction d'épaisseur pour leur transmettre des
- 10 spécifications de correction d'épaisseur.

22. Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les moyens de mesure d'épaisseur comprennent un ellipsomètre.

15 23. Dispositif selon l'une des deux revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de mesure d'épaisseur comprennent un réflectomètre.

24. Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les moyens de mesure d'épaisseur comprennent un dispositif de type
20 ACUMAP™.

25. Dispositif selon l'une des quatre revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de correction d'épaisseur comprennent un dispositif de type RTP XE Centura™.

25

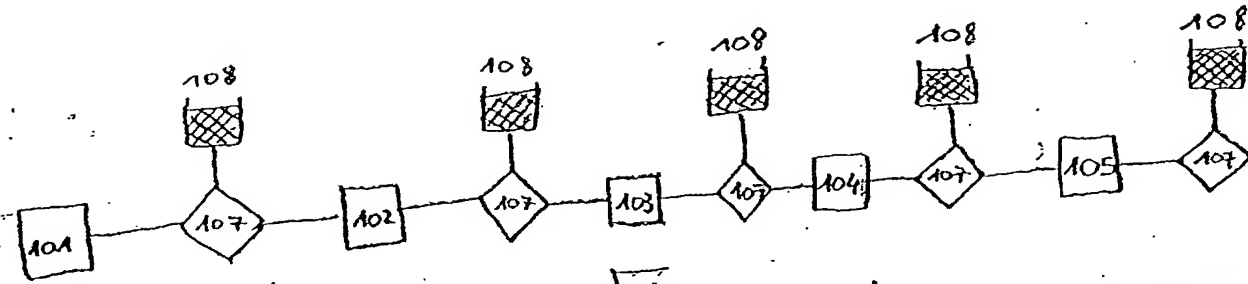


Figure 1:

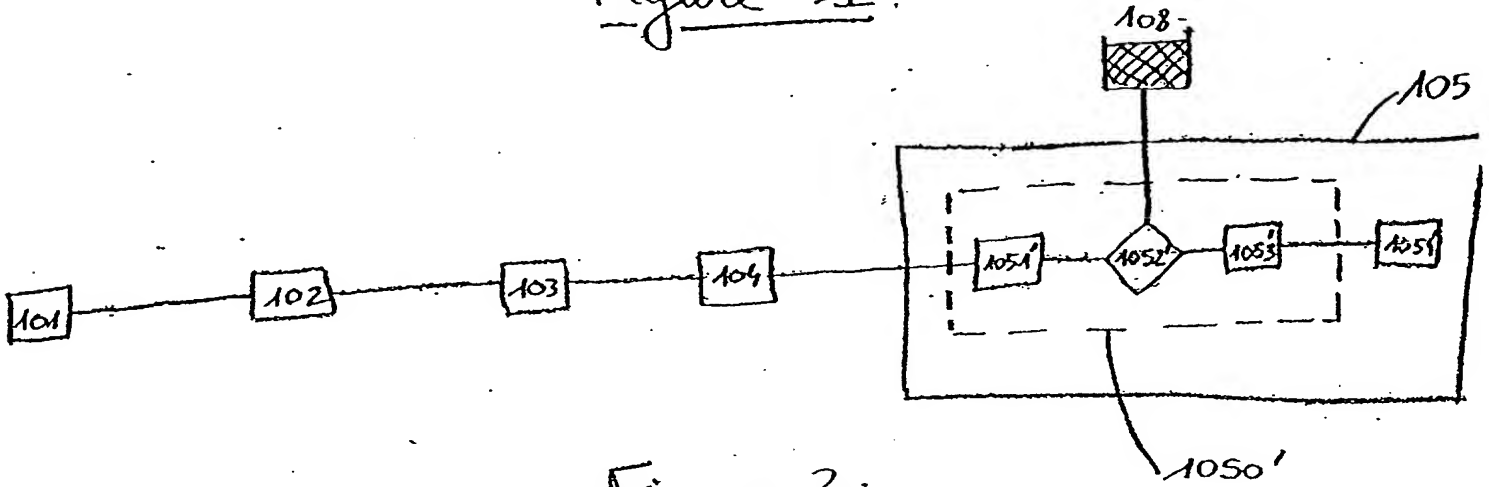


Figure 2:

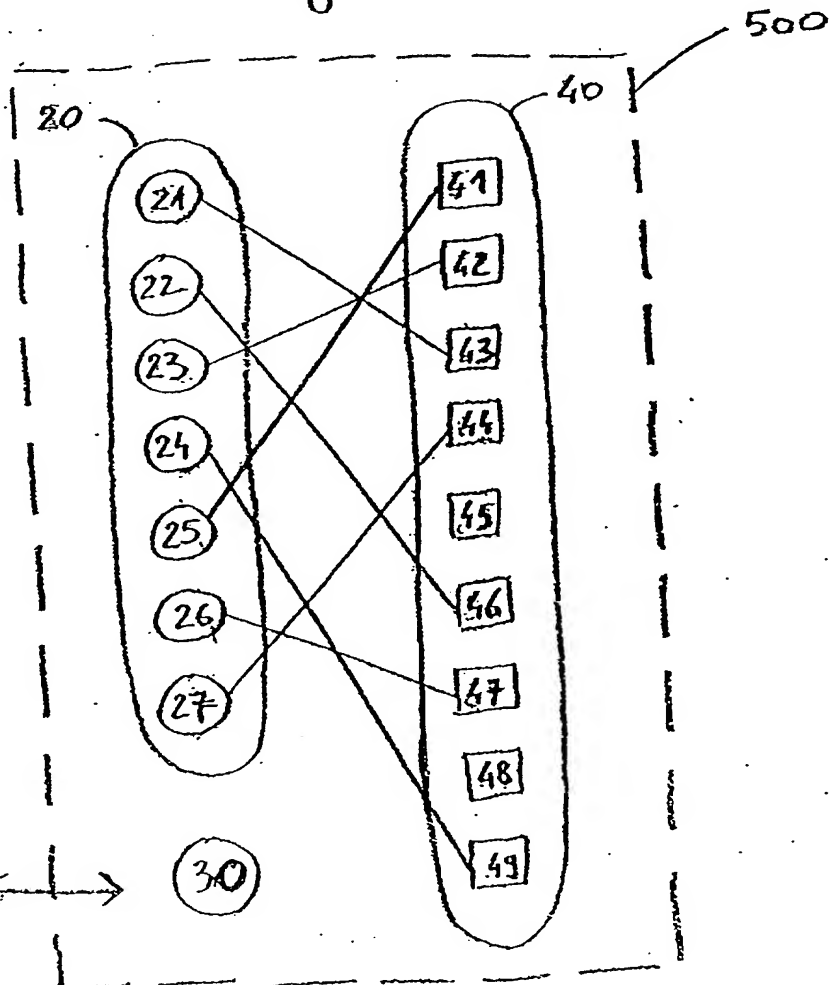


Figure 3:

1 / 7

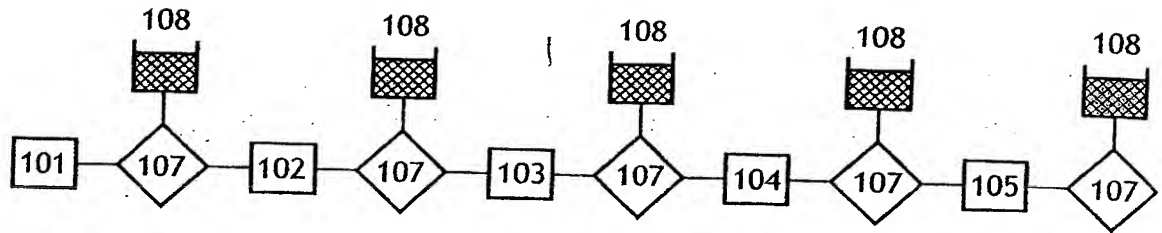


FIG. 1

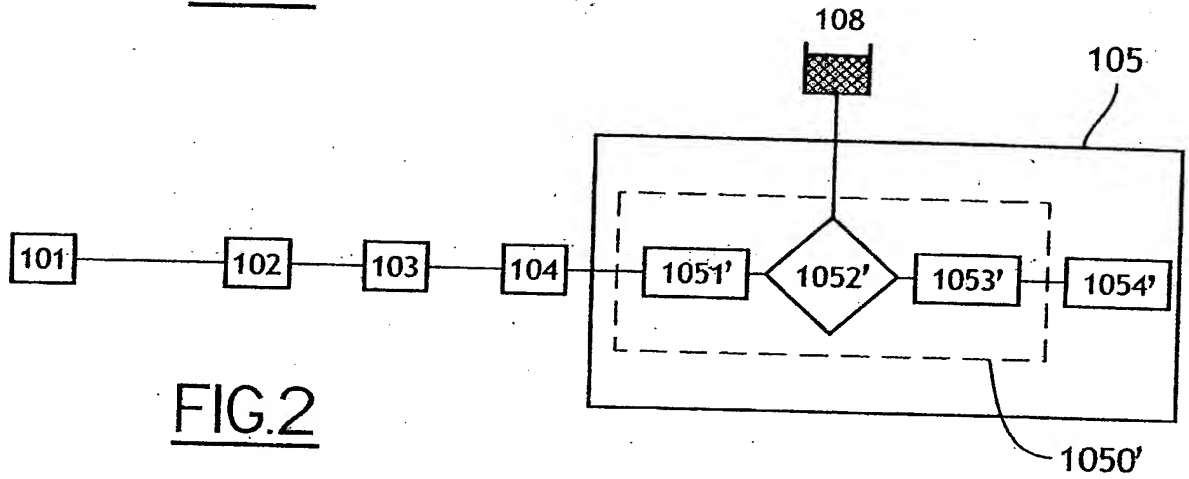


FIG. 2

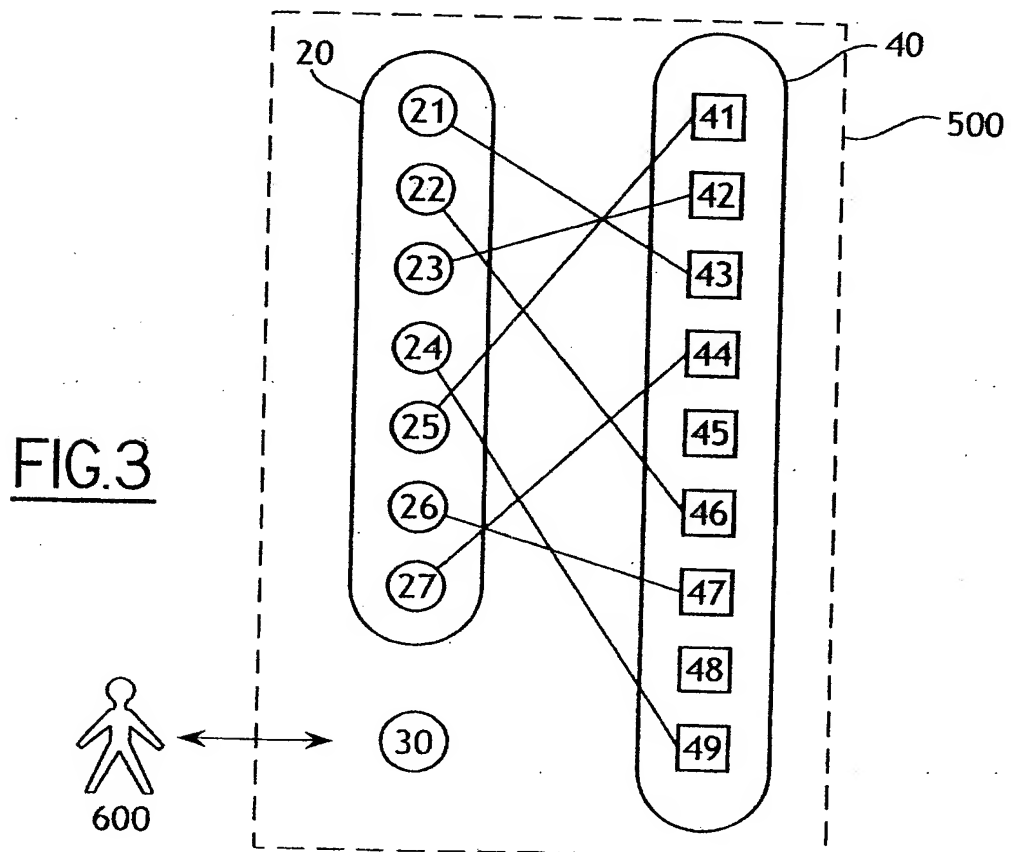


FIG. 3

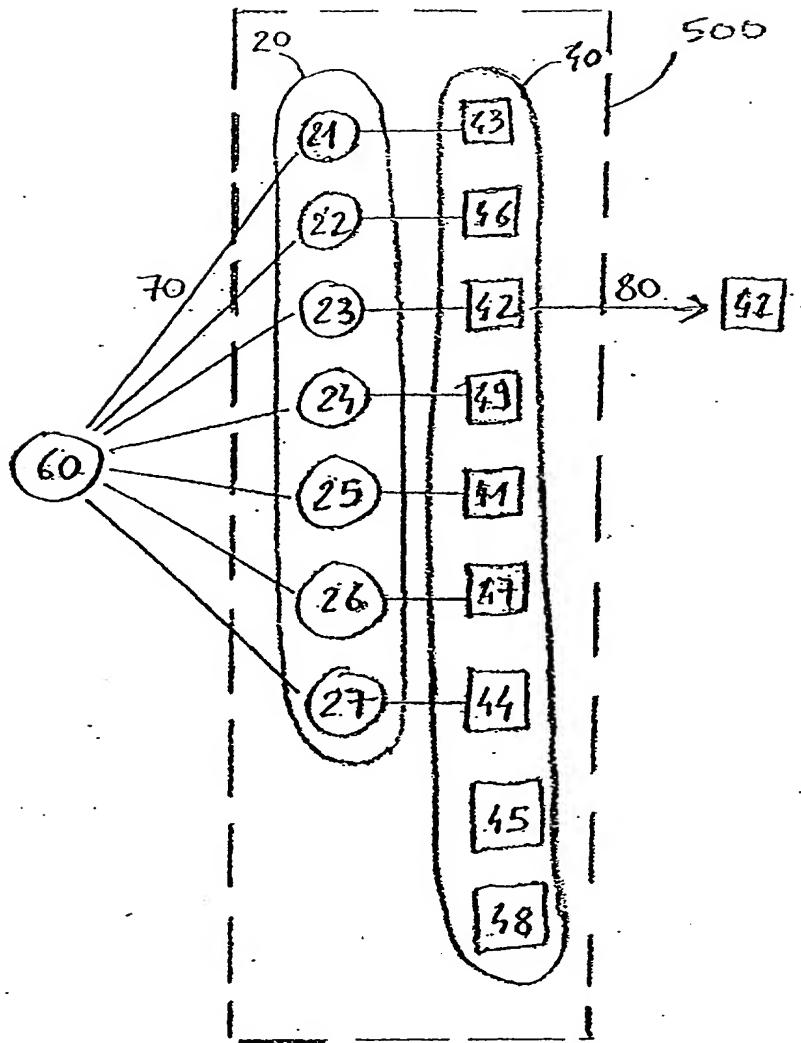


Figure 4 :

2/7

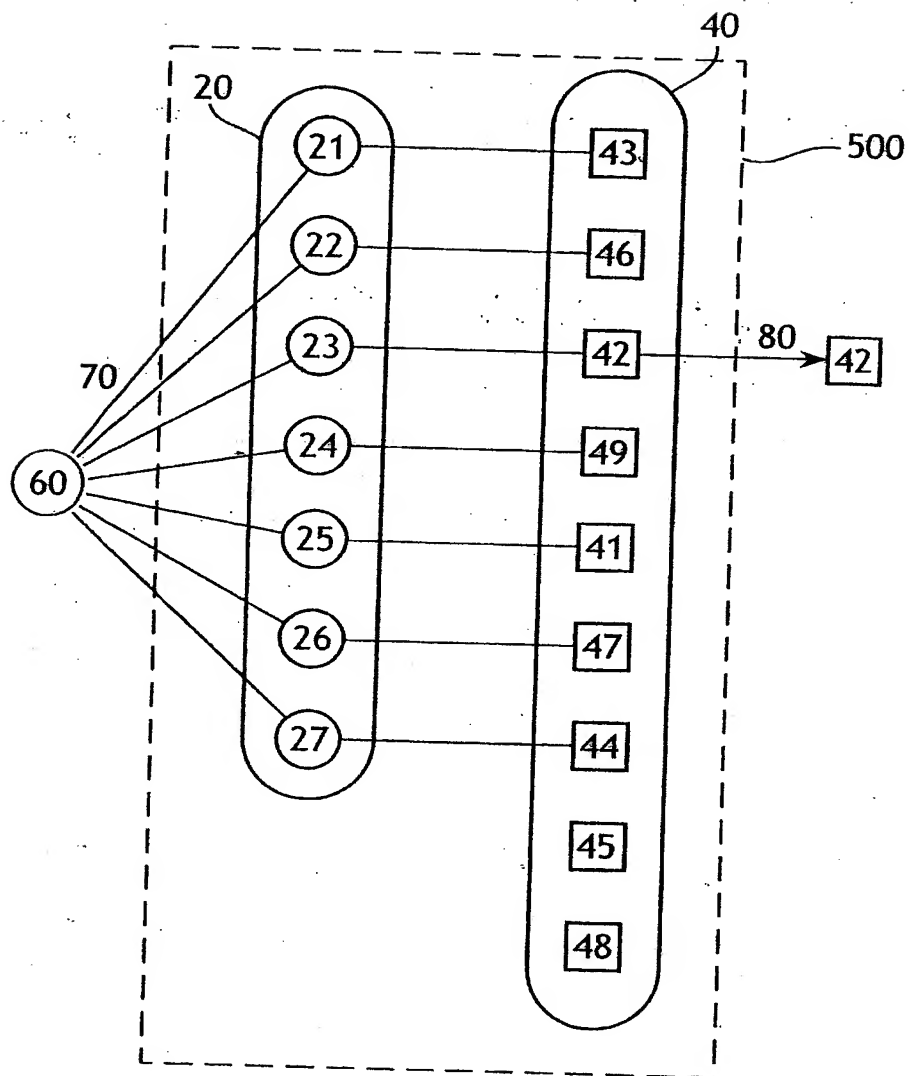


FIG.4

Figure 5

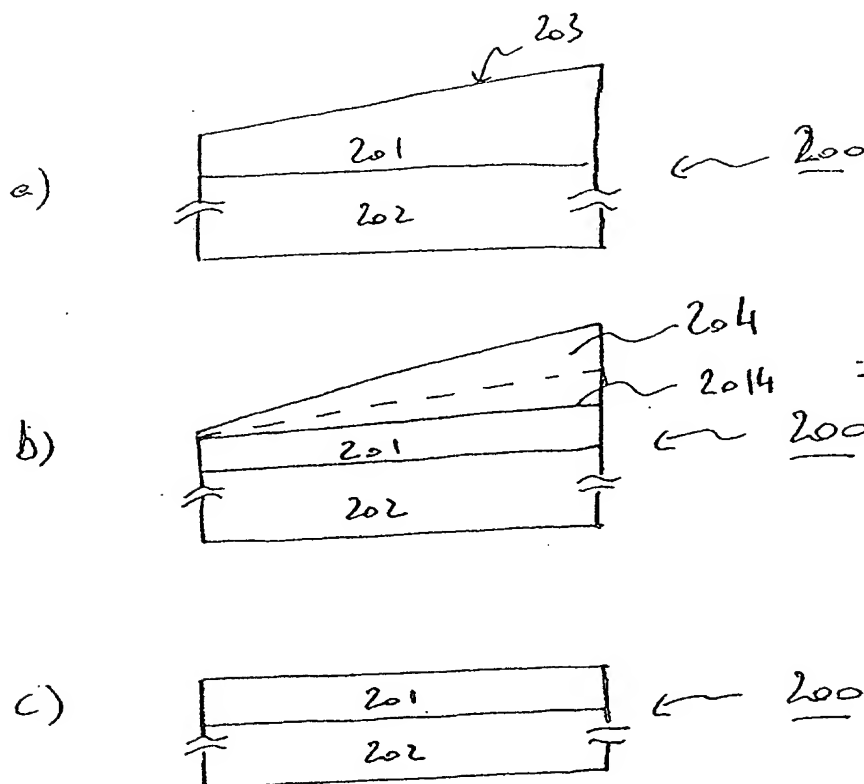
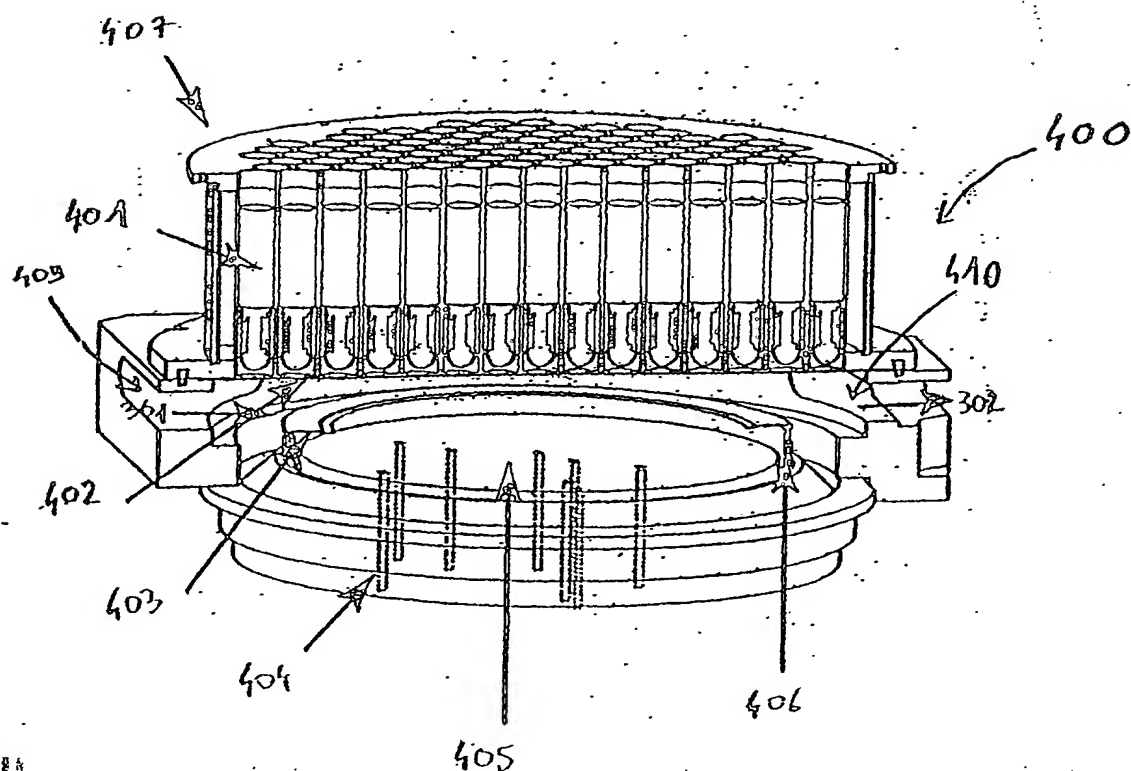


Figure 6



3 / 7

FIG.5

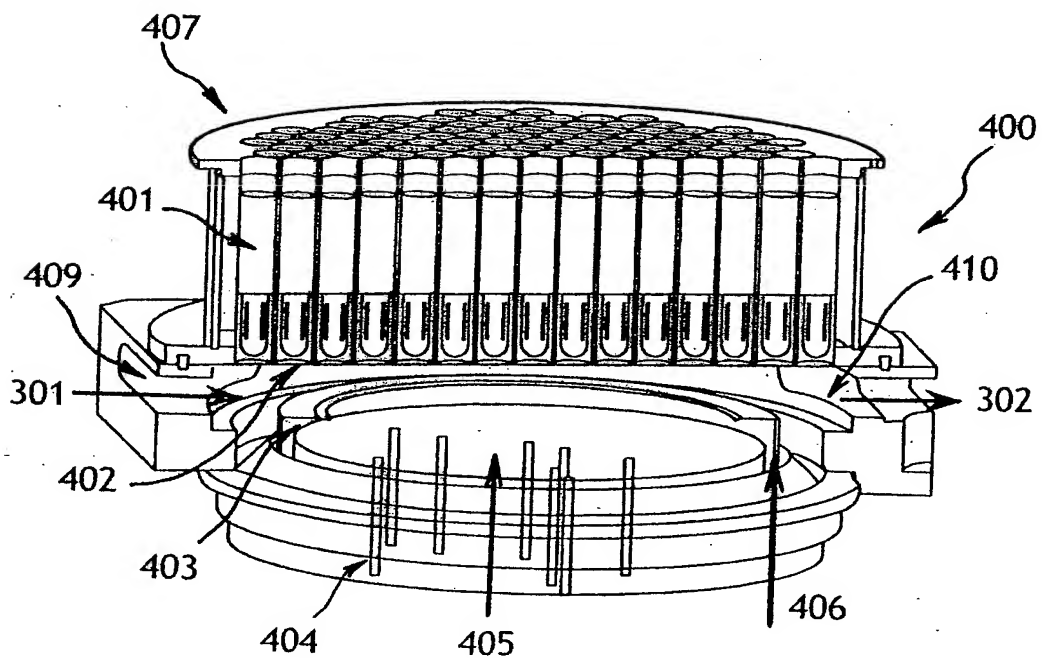
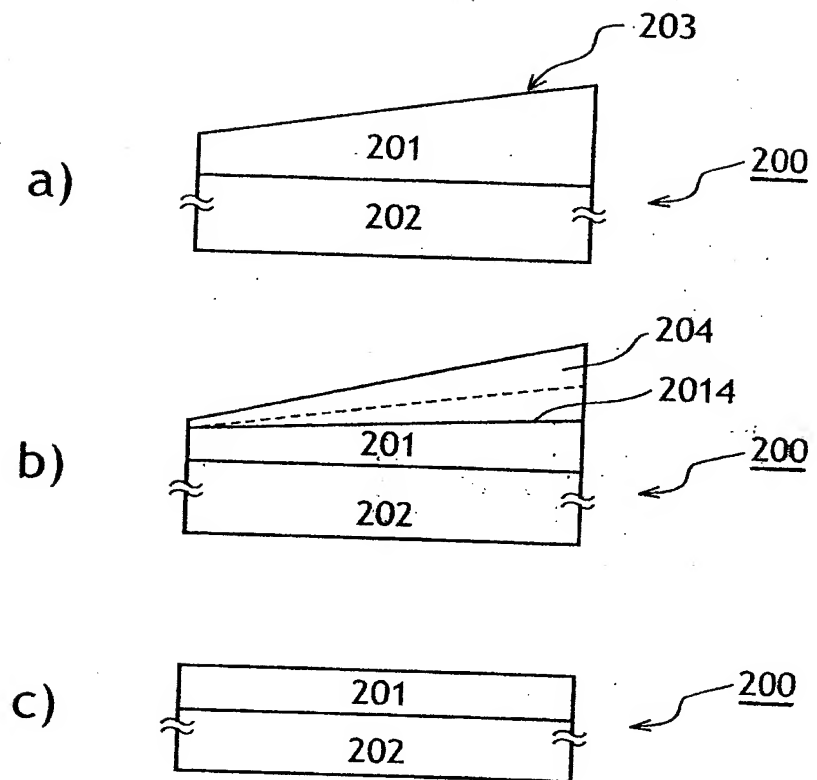


FIG.6

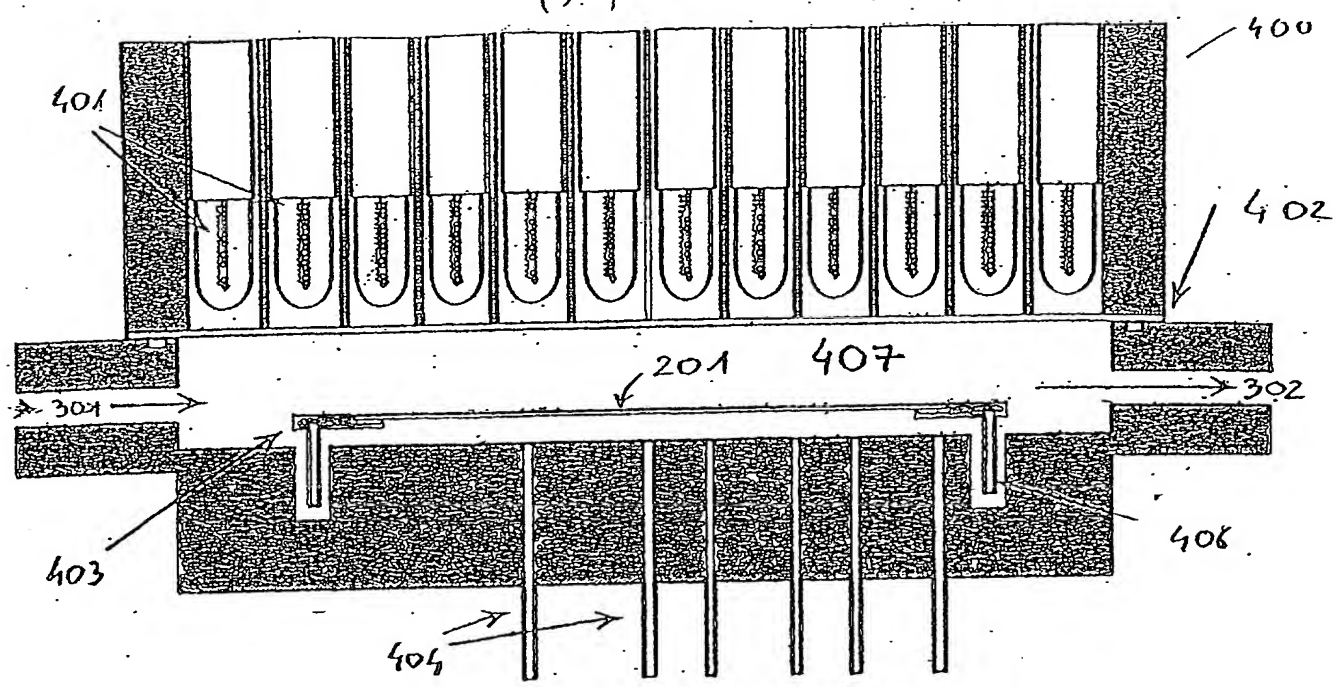


Figure 7:

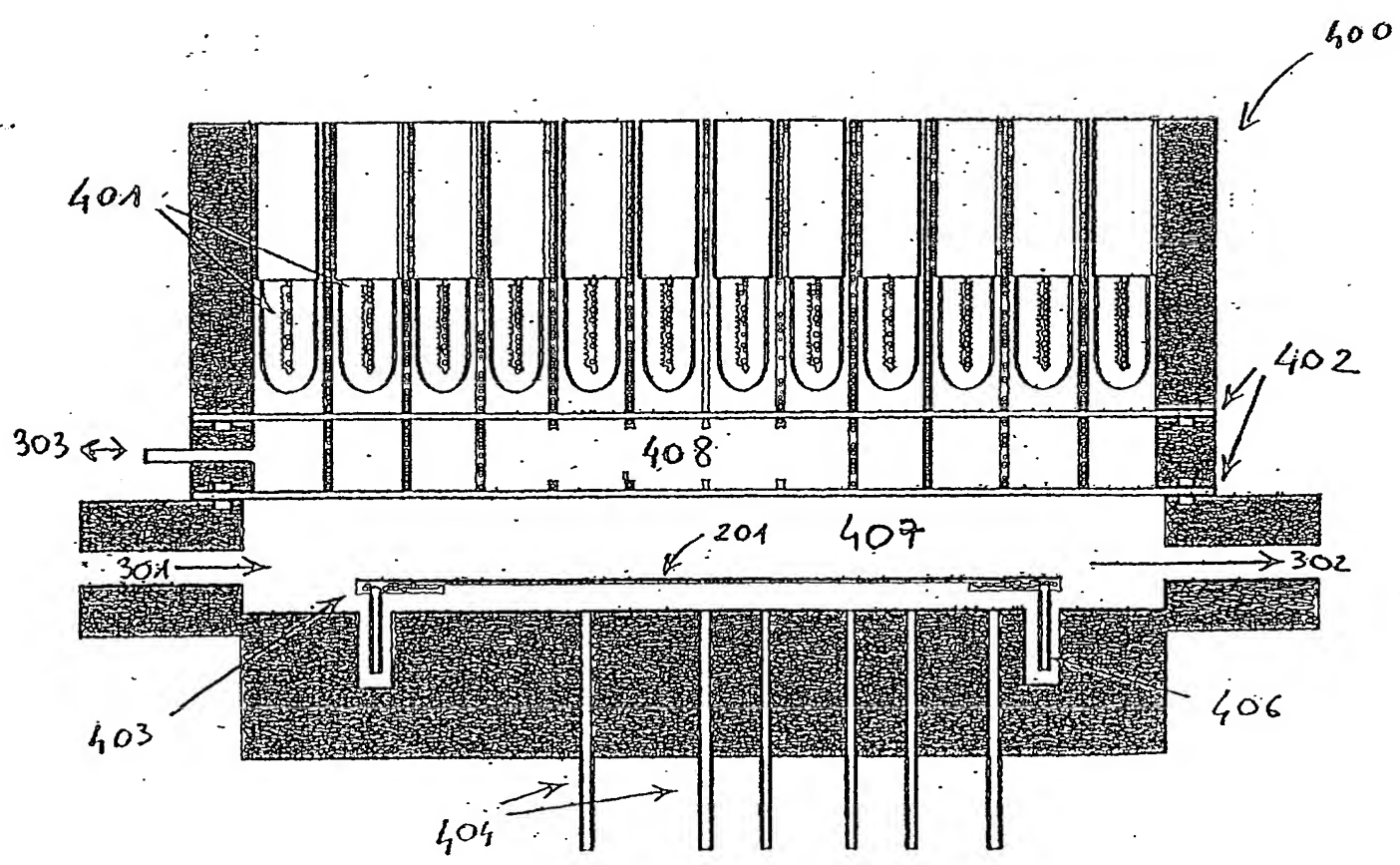


Figure 8

4 / 7

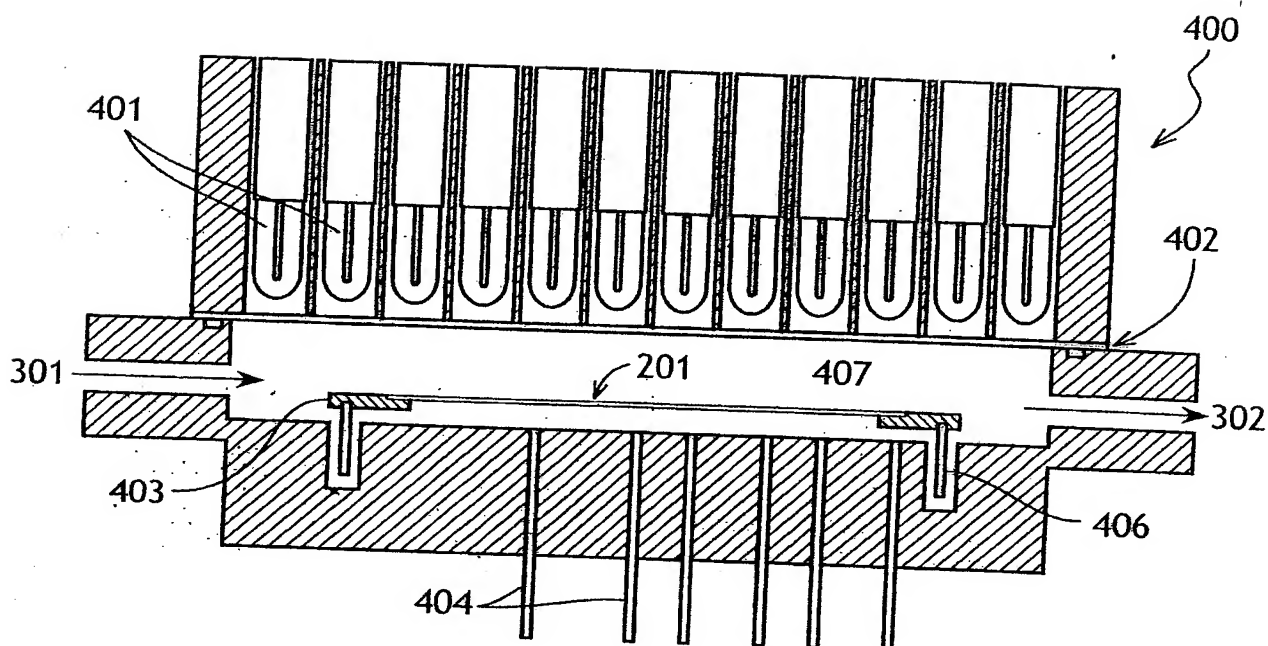


FIG. 7

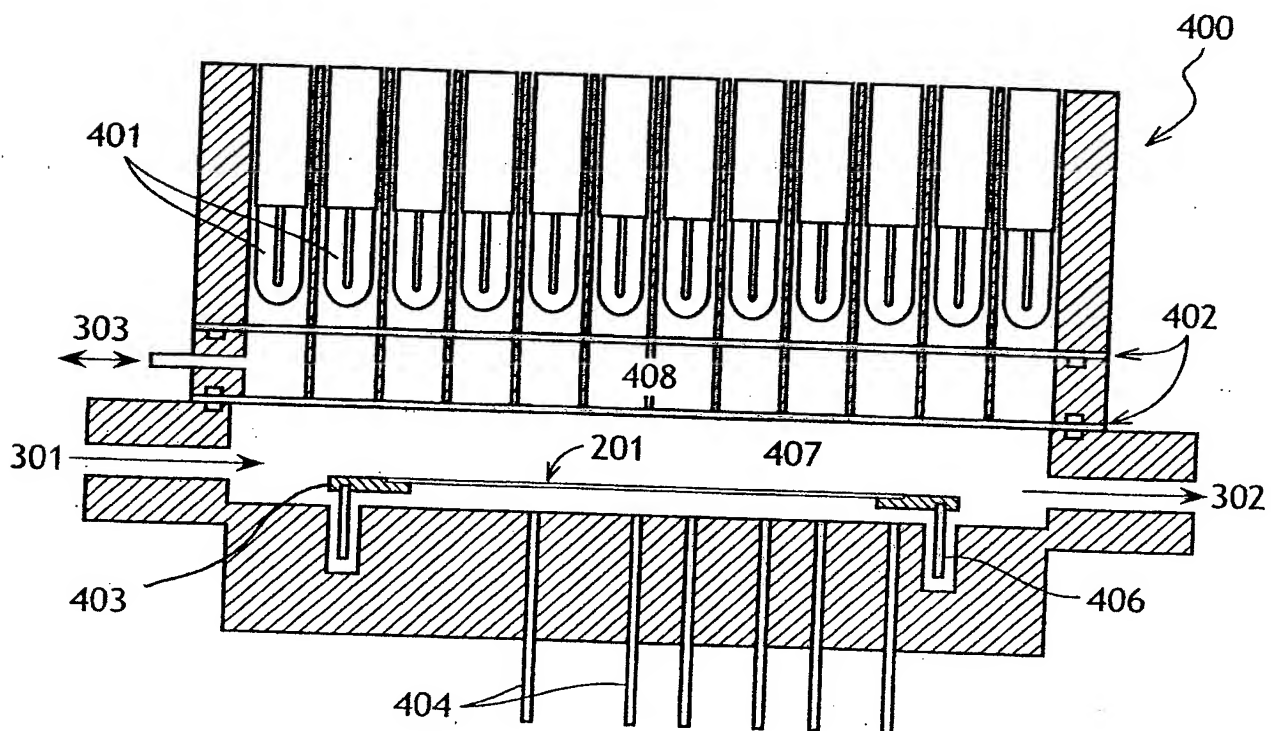


FIG. 8

5/7

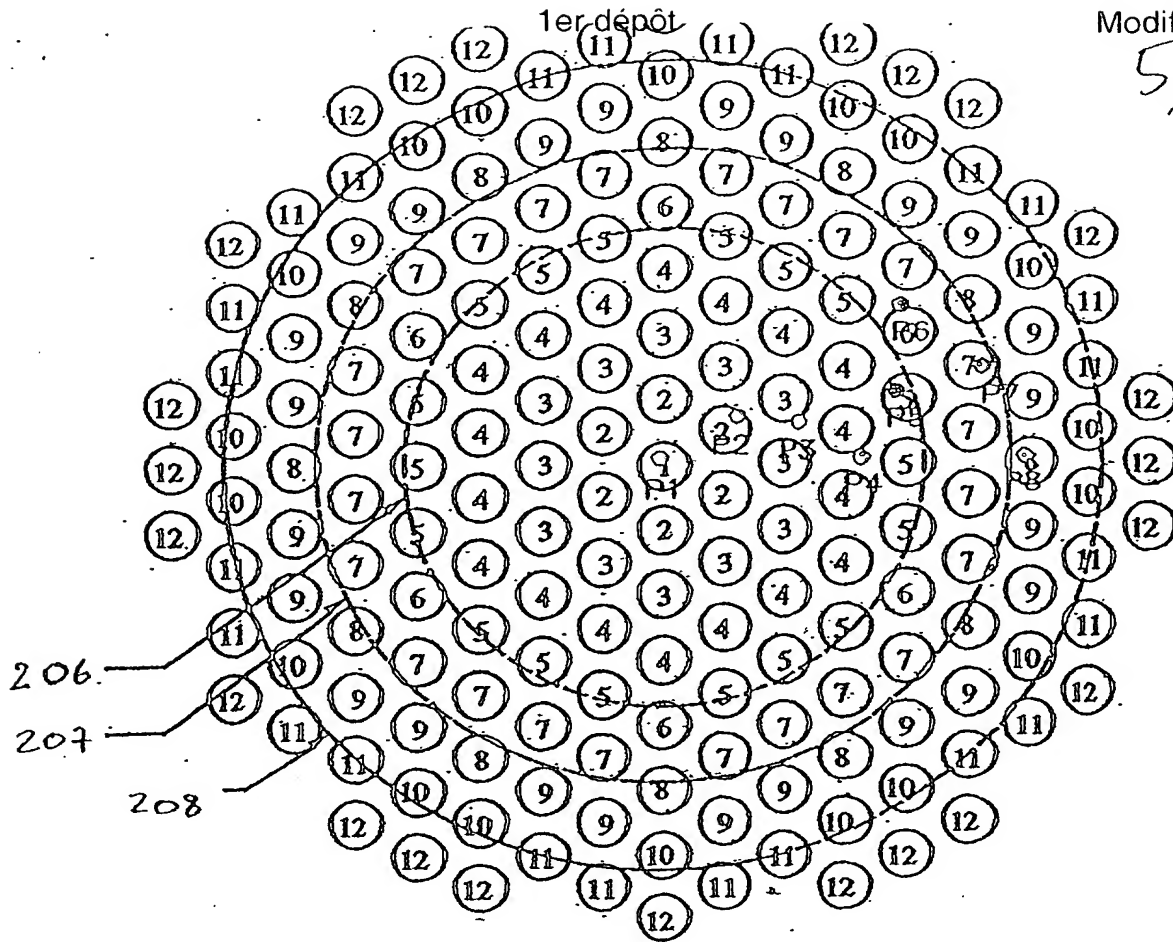


Figure 9.

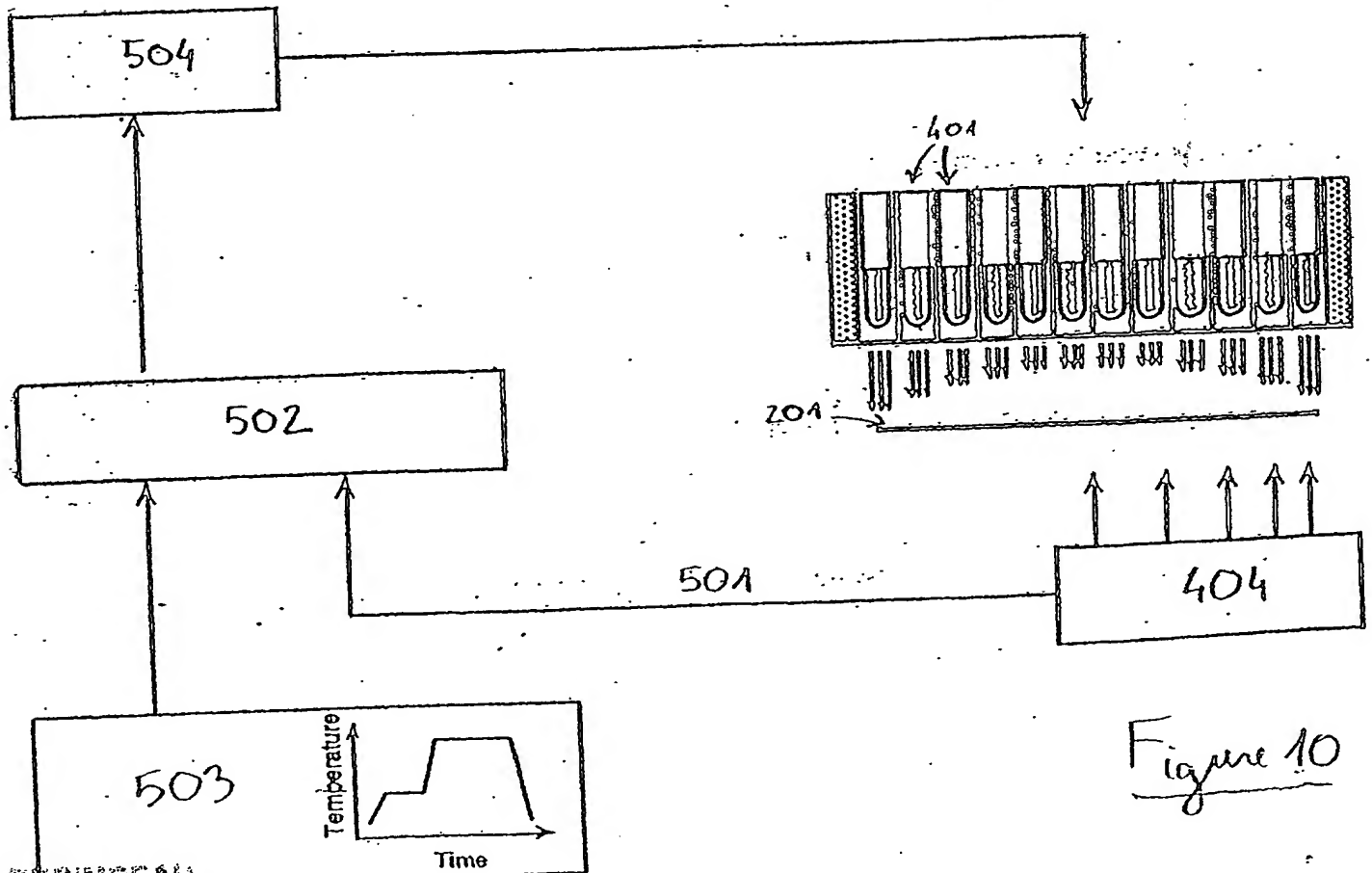


Figure 10

CABINET RECHERCHE

DUPLICATA

certifié conforme à l'original

5/7

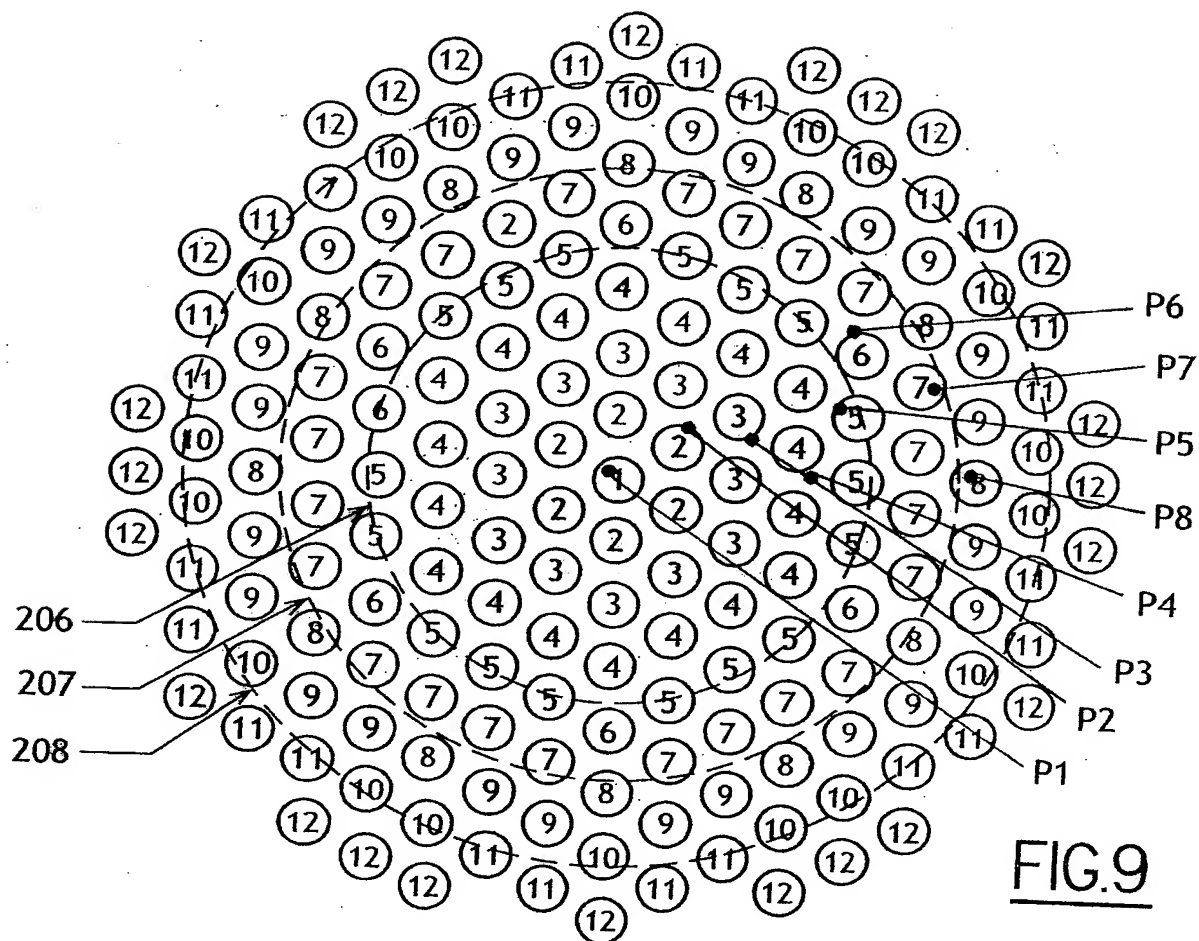


FIG.9

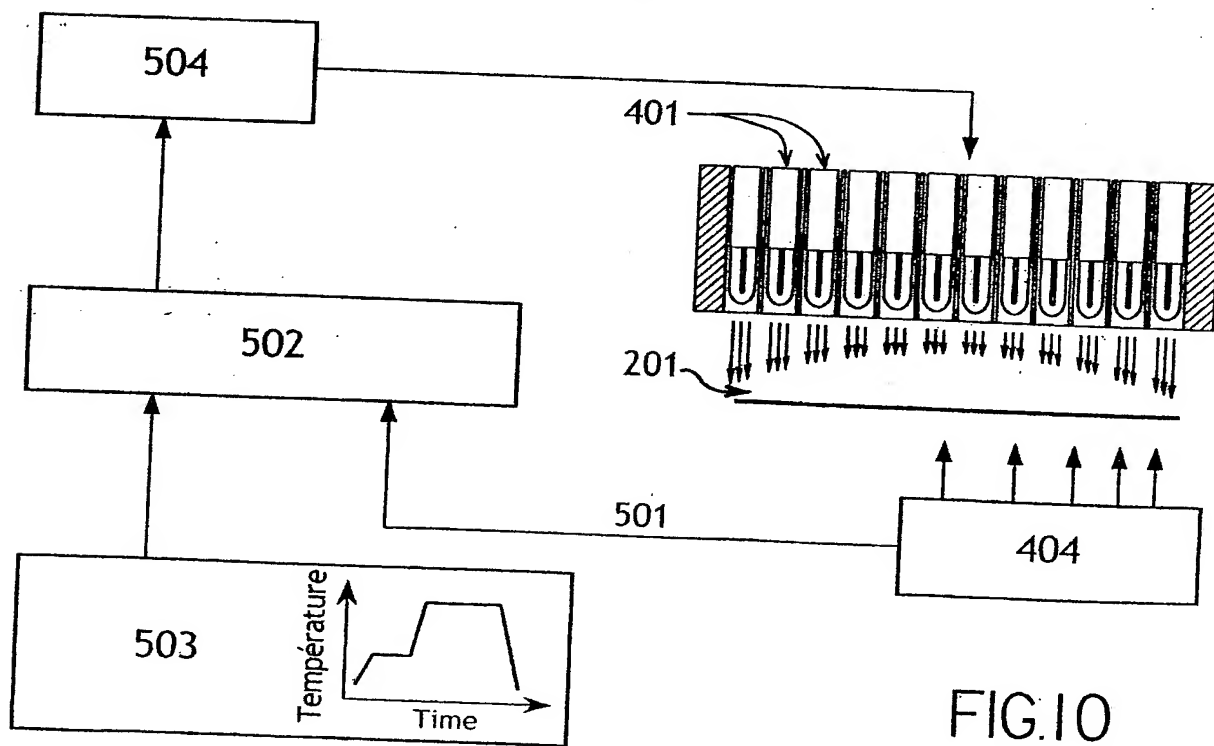


FIG.10

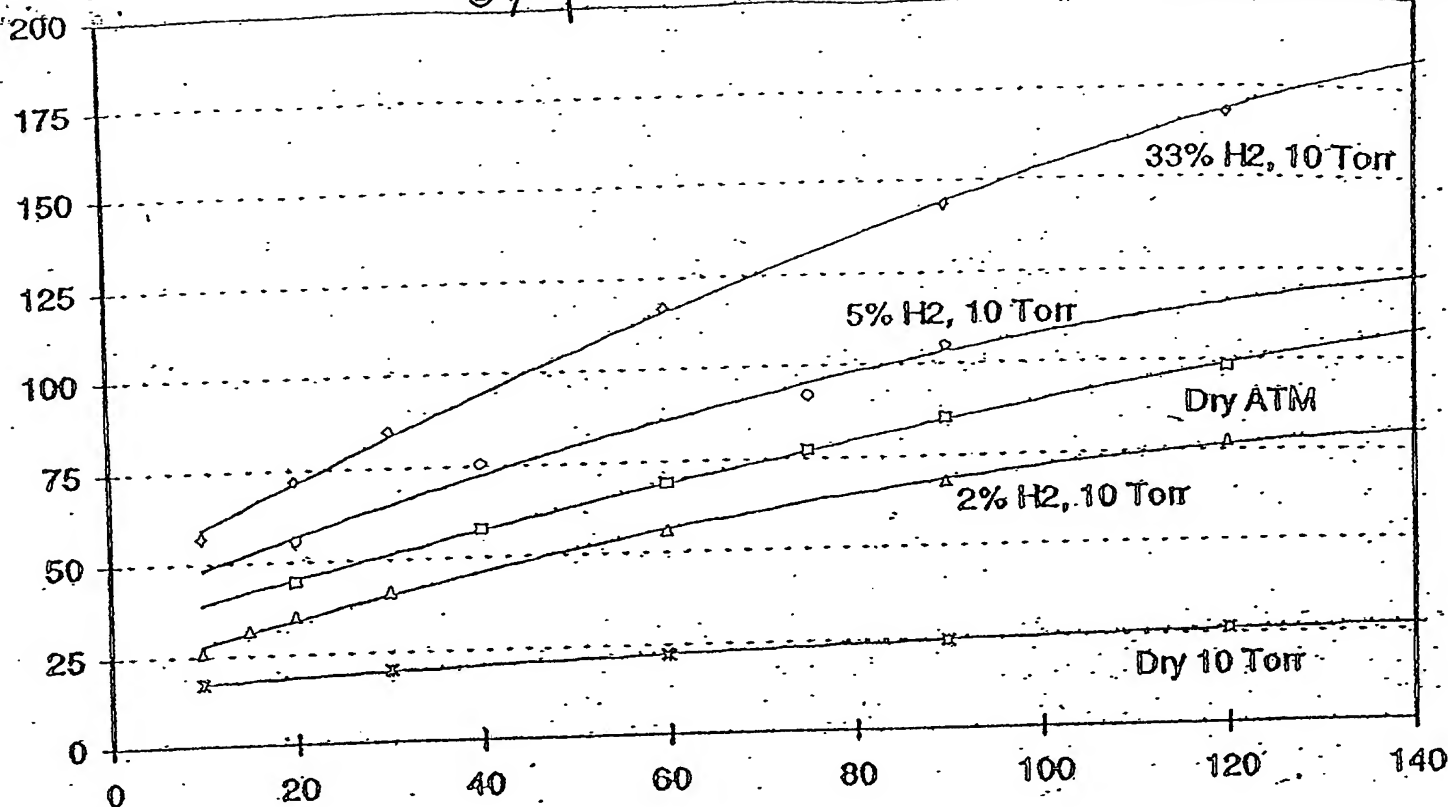


Figure 11.

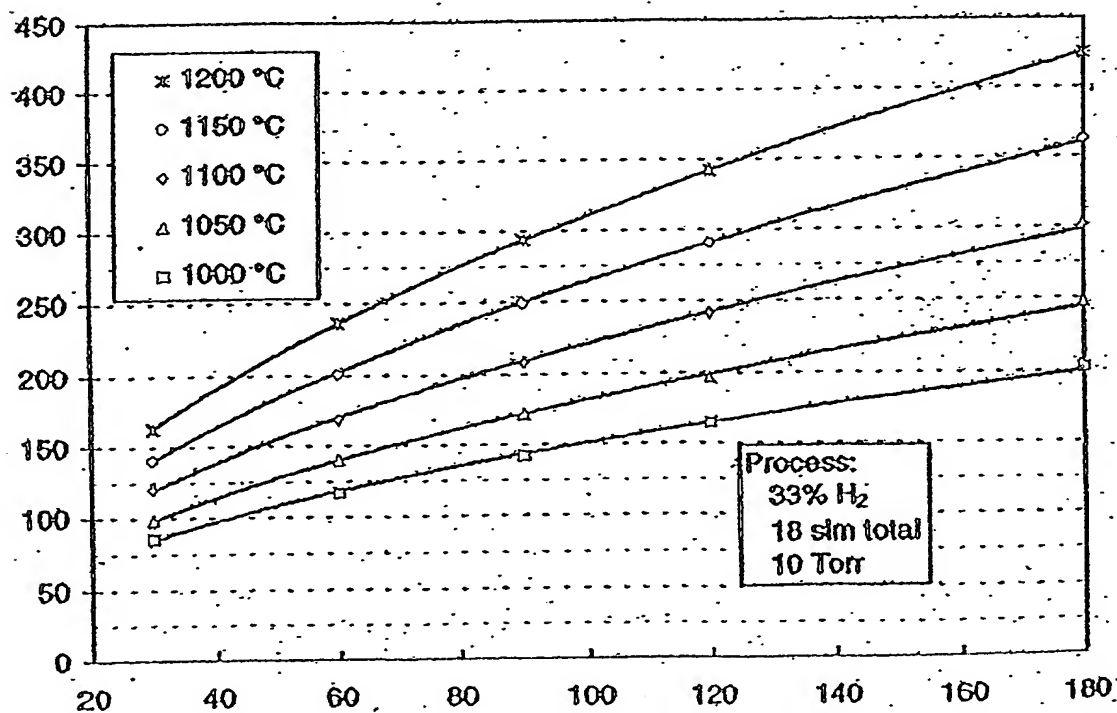


Figure 12.

6/7

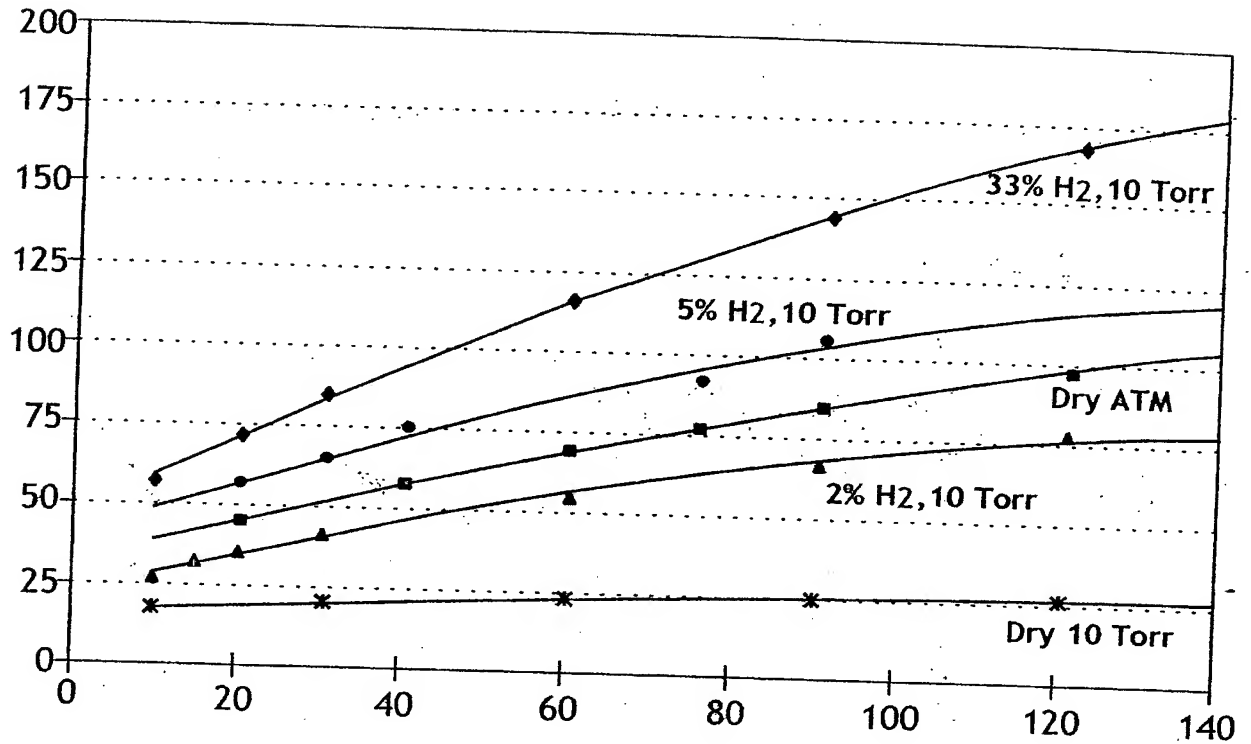


FIG.11

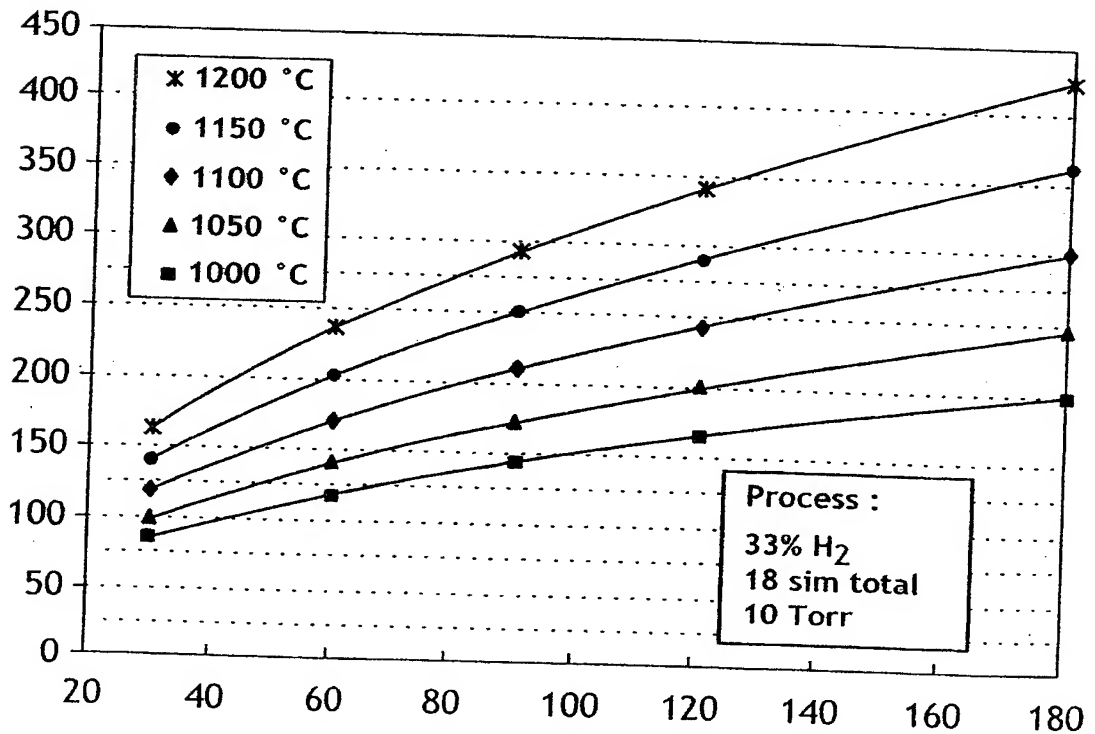


FIG.12

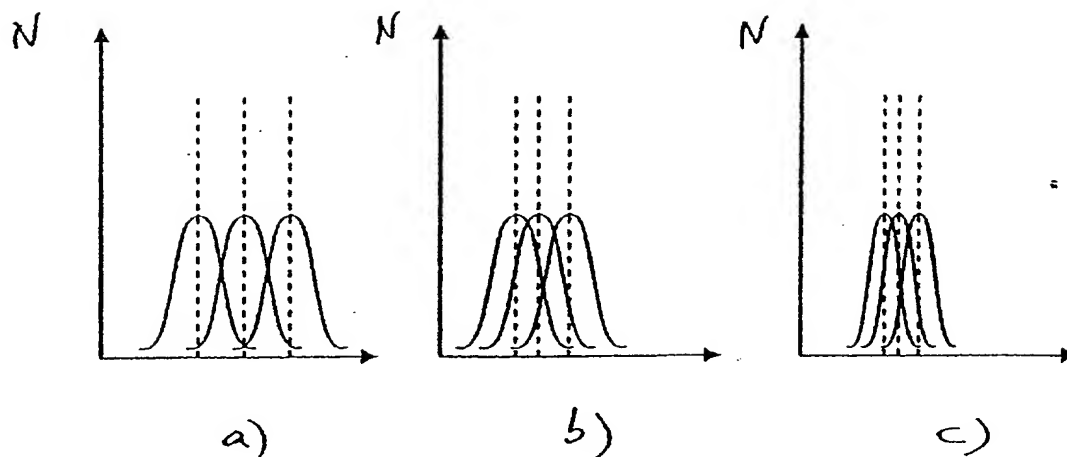


Figure 13

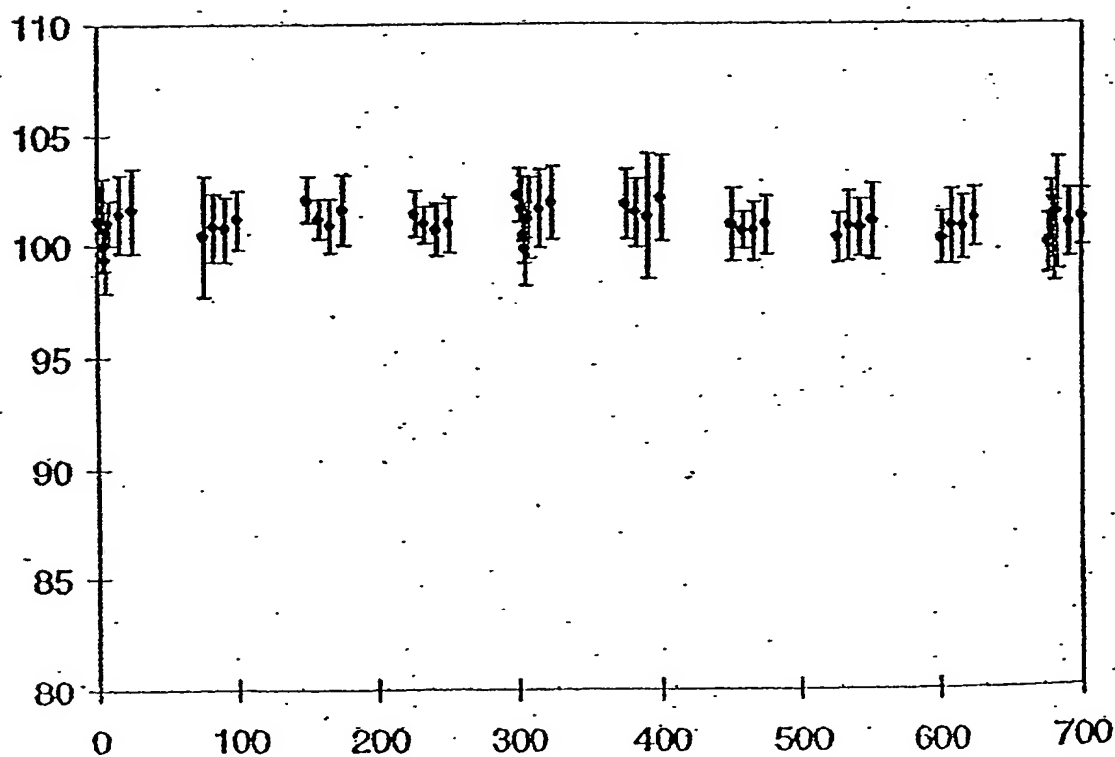


Figure 14:

7/7

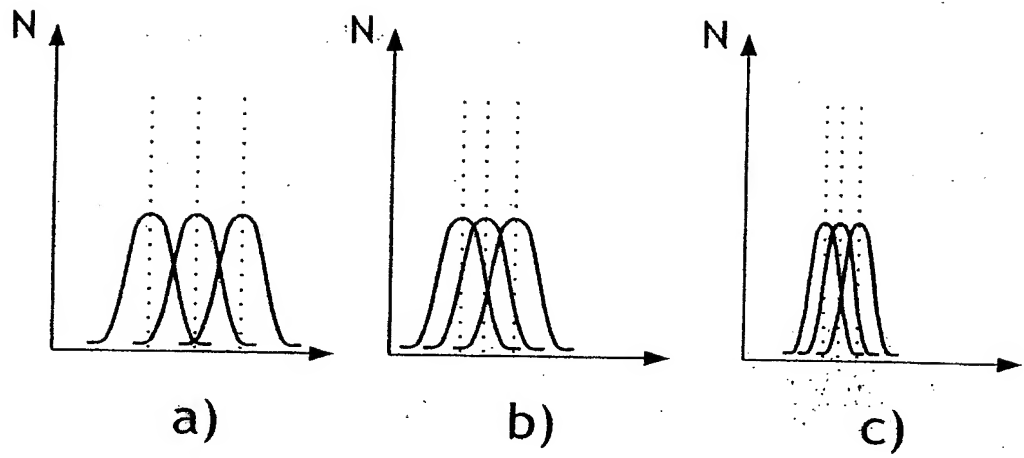


FIG.13

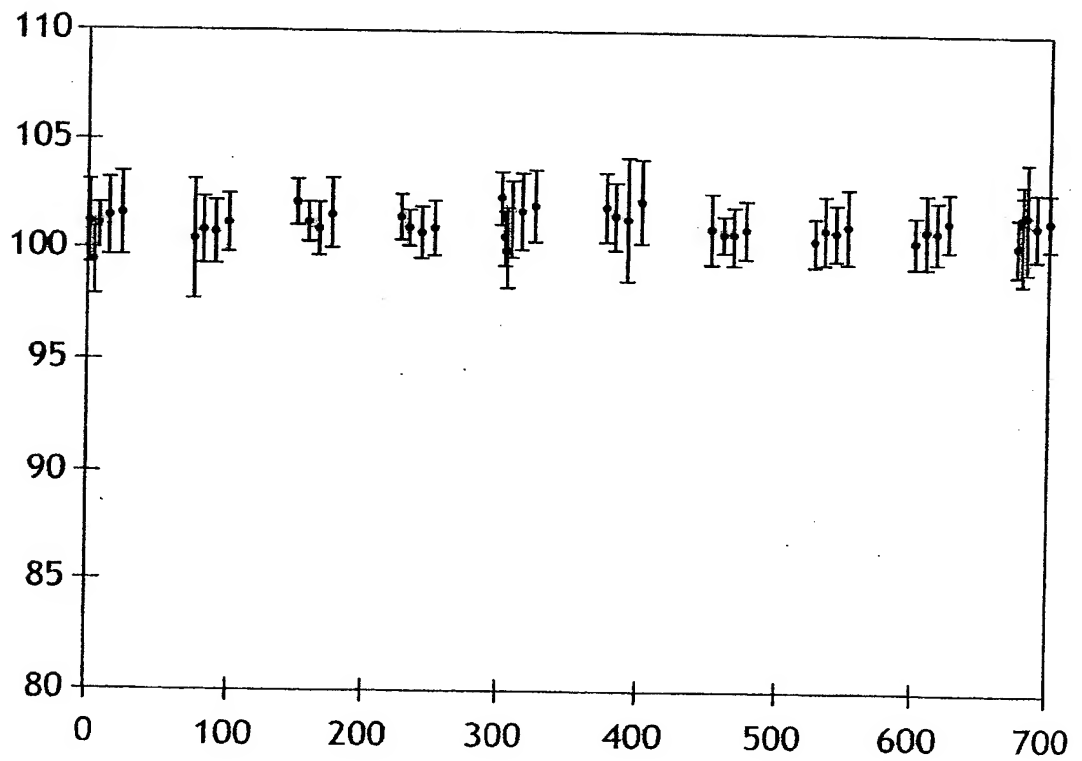


FIG.14



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*03

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / .1.

(À fournir dans le cas où les demandeurs et
les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)		239603 JC	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0210208	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
PROCEDE D'ELABORATION DE COUCHES MINCES DE SEMI-CONDUCTEUR COMPRENANT UNE ETAPE DE FINITION			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES : Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques, 38190 BERNIN - FRANCE			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :			
1 Nom		GHYSELEN Bruno	
Prénoms			
Adresse	Rue	58, rue Georges Maeder 38170 SEYSSINET-PARISSET	
	Code postal et ville	[][][][][]	
Société d'appartenance (facultatif)			
2 Nom		AULNETTE Cécile	
Prénoms			
Adresse	Rue	3, Place des Tilleuls 38000 GRENOBLE	
	Code postal et ville	[][][][][]	
Société d'appartenance (facultatif)			
3 Nom		OSTERNAUD Bénédite	
Prénoms			
Adresse	Rue	26, rue Lieutenant Fiancey 38120 SAINT EGREVE	
	Code postal et ville	[][][][][]	
Société d'appartenance (facultatif)			
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			

